神鋼パンテック技報 1992-Vol.36・No.3 **127** SHINKO PANTEC ENGINEERING REPORTS

目 次

CONTENTS

- 1 乱流撹拌槽の流動解析
- 5 撹拌におけるバッフル効果
- 10 耐熱衝撃性グラス
- 15 薄膜蒸留装置ワイプレンを使った システム紹介
- 20 ヤコブソンミルの紹介
- **23** PMX-98の自動車部品工場への適用
- 28 最新の半導体集積技術と超純水
- 32 でんぷん製造廃水のメタン発酵処理について ーアクアルネッサシス'90計画よりー
- 36 神戸市における 下水の高度処理実験施設の紹介
- 43 バグフィルターの納入実績例(ブラスト集塵)



Computer Simulation of Turbulent Flow in a Stirred Tank

Thermal Shock Resistant Glass

Introduction of Systems on Wiprene (Wiped Film Evaporator)

Introduction of Jacobson Mill

Application of Software Package "PMX-98" to a Parts plant of Car Industry

Latest Semiconductor Integration Technology and Ultrapure water

Methane Fermentation of Wastewater from a Wheat Starch Producing Plant — On the Results of Aqua Renaissance '90 project —

Experimental Sewage Water Reclamation Facility in Kobe City

Example of Application Bag Filter (Blast Dust Collection)

TOPICS



〈写真説明〉

GOLDEP-WHITE製超純水製造装置は、装置 を構成する材料にGOLDEP-WHITE材を使用 したことにより、超純水中のTOCや金属類を極 微量におさえることができるようになりました。 この材料は熱水やオゾン添加水を使用出来るなど 優れた特長を有しているため、今後は超純水製造 装置ばかりでなく半導体製造分野などにおけるさ まざまな装置への適用が期待されます。

By employing GOLDEP-<u>WHITE</u> components, the ultrapure water production system provides high quality ultrapure water with a minimum TOC and metal content. As the GOLDEP-<u>WHITE</u>, is a material capable for use in hot water and ozonated water, diversified applications to semeconductor monufacturing are expected in addition to ultrapure water production.

⁴⁶ 社内ニュース

乱流搅拌槽の流動解析

Computer Simulation of Turbulent Flow in a Stirred Tank



Turbulent flow and mixing in a baffled tank stirred with 4-pitched paddle impeller were investigated. Its velocity distribution was measured using laser doppler anemometer, and concentration response curves were measured at one point by means of the electro conductivity method. And also the detailed velocity distribution was calculated using computational fluid dynamics based on k- ε model, and the concentration response curve at the measuring point was simulated. Then the computed results were compared with the measured ones. The main results obtained in this study are as follows.

(1) The computed velocity distribution qualitatively agreed with the measured one. The maximum error of the velocity computation was 16 % of the impeller tip speed. Computed turbulent energy was considerably lower than the measured one at the most of the measuring points, and at a point the computed value could be as small as 10 % of the measured one. (2) The computed concentration response curve deviated from the measured ones. However computed and measured mixing times were 20sec and 16 sec, respectively, to give an impression of fair agreement.

まえがき

本報告では、低粘度液の乱流撹拌に広く用いられている 傾斜パドル翼付乱流撹拌槽について、この撹拌槽内の詳細 な3次元流速分布を、化学装置内の乱流解析によく用いら れる2方程式乱流モデル(以下 k-ε モデルと略称)を用い た数値解析法とレーザードップラー流速計による流速測定 結果を併用した簡略解析法により求めた。また得られた速 度場を利用して濃度の拡散方程式を解析することにより拡 散物質の濃度応答曲線を求めた。そして得られた計算値を レーザードップラー流速計による流速ならびに電気伝導度 法による濃度応答の実測値と比較することにより k-ε モデ ルを用いた乱流撹拌槽内流動解析の可能性を検討したので 次に報告する。

1. 実験

第1図に検討の対象とした撹拌槽を,第2図に実験装置 及び流速測定システムの概要を示す。撹拌槽には内径400 mmの2:1半楕円下鏡を有する透明アクリル製円筒を, 撹拌翼には翼径200mm, 翼幅40mm, 傾斜角度45度の4 枚傾斜パドル翼を撹拌槽中心最下部より150mm上部に設 置して使用した。また邪魔板には槽内径に対して10%幅の 板状邪魔板を90度間隔で4枚設置した。レーザー光線の屈 折をおさえるためにアクリル製円筒槽をアクリル製角型槽 内に設置して双方に試験流体(水)を満たした。なお円筒 槽には槽中心最下部より500mm高さまで水を満たした。

流速の測定には後方散乱型ファイバータイプ2次元レー ザードップラー流速計(DANTEC 社製)を使用し,円周 方向と軸方向の2方向瞬間流速を同時測定した。また,第 2図に示すようにプローブ位置を移動させて半径方向流速 を測定した。各点に対してサンプリングされた20000個の 変動流速をアンサンブル平均して平均流速を求めた。

混合時間の測定には KCL 水溶液による 電気伝導度法 (パルス応答法)を用いた。第2図に示すように電気伝導 度プローブを邪魔板下部に設置し,このプローブから検出 されるKCL濃度変動に基づく伝導度変化をレコーダーに 記録した。

実験条件は流速測定及び混合時間測定共に翼回転数 180 rpm, 撹拌レイノルズ数1.2×10⁵である。



第1図 解析に使用した傾斜パドル翼付撹拌槽モデル Fig. 1 Schematic diagram of stirred tank with 4pitched paddle impeller used in this work



 $0.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \longrightarrow$

2. 数値計算

本計算では有限体積法による市販の汎用熱流体解析コー ドを使用して流速分布及び混合過程を求めた。乱流モデル には等方性乱流の 仮定を施した標準 *k*-ε モデルが 用いら れている。従ってここでは,時間平均連続の式,時間平均 Navier-Stokes 方程式 (u, v, w, p), 乱流エネルギー (k) 及び粘性消散率(€)の輸送方程式を連立させて数値解析を 行った¹⁾。

第3図に境界条件を示す。槽内壁及び邪魔板表面には3 方向の速度ゼロを与え,壁近傍を対数則速度分布で近似し た。自由表面(液面)にはすべりあり条件を与え、これを 水平に近似した。この近似は実際のテスト槽での観察結果





第2図 実験装置及び流速測定システム Fig. 2 Experimental apparatus and velocity measuring system

から,液面での凹凸は小さく水平に近似しても妥当である と考えられることによる。計算の簡略化のため翼部分を円 柱状の検査要素で近似し、この円柱検査要素表面全域に流 速の実測値(u, v, w)を与えた。この際,検査要素に流 入する流量と流出する流量に等しくなければならない。ま た円柱検査要素から流体が流出する部分には乱流エネルギ - kの実測値を与えた。このように,解析系内で実際の撹 拌翼の回転を再現せずに翼周辺に境界条件として実測値を 与える理由は、一般の汎用熱流体解析コードでは撹拌翼と 邪魔板との相対的位置を時間の経過と共に変化させながら 移動境界問題として解析することが出来ないことによる。

(注記:現在汎用熱流体解析コード製作各社が, 邪魔板付 き撹拌槽内の流動解析を、回転円筒座標系と静止座標系を 併用した移動メッシュ方式で解析できるようにするコード 開発に乗り出している。)

混合過程の計算には濃度の輸送方程式を用いた。濃度の 輸送方程式中の u, v, w に上記流動解析により得られた時 間平均流速 u, v, w を代入して数値計算した。濃度方程式 の数値解析では液面付近より一定濃度のトレーサーをパル ス的に投入し、そのトレーサーが槽内で拡散する過程を濃 度応答曲線として検出した。濃度応答を追跡するポイント は実験で伝導度プローブを設置した場所と同一とした。

計算機にはエンジニアリングワークステーションを使用 した。流動解析のみに要するCPUは圧力変動が充分小さ くなって定常状態に達するまで約120時間であった。解析 に用いた格子数は $23(\mathbf{r}) \times 44(\theta) \times 46(\mathbf{z}) = 4652$ 個である。

結果及び考察 3.

3.1 流動特性

第4図は邪魔板前面における r-z 断面内流速分布の数値 計算結果である。槽内では翼下部域より吐出された流体が

神鋼パンテック技報





第7図 乱流エネルギー分布 Fig. 7 Contours of computed turbulent energy

第5図 r-z 面内流速分布の実測値 Fig. 5 Measured velocity vectors in r-z plane

槽底付近に衝突して反転し、撹拌槽上部に達したあと再び 翼上部から吸い込まれるという1つの循環流を形成する。 また翼直下付近では弱い上昇流が生じており翼下部からの 多少の吸い込みが予測されるものの、その流速は遅く流体 の停滞域となる可能性がある。

これら計算結果の一部を実測値と比較した。まず定性的 な一致度を検討した。第5図は邪魔板前面における r-2 断 面内の流速分布の実測値を示したものであり,第4図で観 察した断面に相当する。翼より吐出された流体が形成する 循環渦の大きさ及びその中心位置は第4図に示す計算結果 とほぼ一致する。第6図は邪魔板間の r-z 断面内における 軸(第6図(a))及び半径方向(第6図(b))のそれぞれの流 速分布の計算値と実測値を比較したものである。計算では 境界条件として翼近傍の流速の実測値を与えているので, 翼に近いほど両者は比較的よく一致するが,翼から離れる に従い計算値と実測値との間に偏異を生じる。流速の計算 値と実測値との間には 翼先端速度に対して最大16%の誤 差を有することがわかった。

第7図は r-z 断面内における乱流エネルギー分布の計算 値を等エネルギー線として示したものである。乱流エネル ギーは翼付近で大きく,翼から離れるにつれて小さくなる。







第8図 乱流エネルギーの計算値と実測値との比較





第9図 混合過程の計算値と実測値との比較 Fig. 9 Comparisons of computed and measured concentration fluctuations

第8図は乱流エネルギーの計算値と実測値を比較したもの である。計算値は実測値に較べてかなり低めに評価され, その大きさも実測値の10%程度になる所もある。

3.2 混合特性

第9図は 混合過程の 計算値と 実測値を 示したものであ る。実測値の棒線は、混合過程でのKCL濃度の応答曲線 を10回測定し、そのばらつきの幅を表している。混合過程 の計算値と実測値はいずれも時間の経過と共に濃度変動を 繰り返し,ある時間以降になると一定値に漸近する。計算 値は実測値よりも遅く立ち上がり, 濃度応答全体及びその 大きさに計算値と実測値との間で偏異を生じている。しか し濃度の最終漸近値の±2%以内に達するまでに要する時 間は計算値及び実測値でそれぞれ20秒と16秒でありその誤 差は20%である。混合時間の計算値と実測値との誤差が流 速, 乱流エネルギー及び濃度応答の計算値と実測値との間 の誤差ほどに大きくない理由として、流速の計算値は実測 値よりも速く, 乱流エネルギーの計算値は実測値よりも小 さく評価されることによる両者の相乗効果があげられる。 現状ではそれぞれの誤差要因が混合時間に及ぼす影響を解 明するには至っておらず、この要因の解明は今後の課題と して残された。

むすび

k-ε モデルによる数値解析法とレーザー流速計により測定した流速データを併用して乱流撹拌槽内流速分布及び混合過程の数値解を求め、これらを実測値と比較し次に示す結果を得た。

- (1) 計算及び実測による両者のフローパターンは定性的 によく一致するものの,流速の計算値は翼先端速度に 対して最大16%の誤差を有する。乱流エネルギーの計 算値は実測値に較べて低めに評価され,その大きさも 実測値の10%程度になる場所がある。
- (2) 混合過程を表示する濃度応答の計算値と実測値との 間には偏異が認められる。しかし濃度の最終漸近値の ±2%以内に達するまでに要する時間の計算値と実測 値はそれぞれ 20秒と 16秒でありその誤差は 20%であ る。

本解析により,数値計算による撹拌槽内流動と現実のそ れとの間で,流速や混合時間等の数値を定量的に評価した 時に見逃せない誤差を含むことを明らかにした。実用問題 にそのまま応用するには計算精度を十分考慮に入れた取り 扱い方が望まれる。

い力か望ま	れる。	
使用記号	С	: 濃度変動
	Со	:均一化濃度
	k	:乱流エネルギー
	Р	:時間平均圧力
	r	:半径方向
	u	:時間平均流速(半径方向)

- v :時間平均流速(周方向)
- w :時間平均流速(軸方向)
- z : 軸方向
- : : 粘性消散率
- θ : 円周方向

〔参考文献〕

1) 高田一貴, 佐藤栄祐, 菊池雅彦: 神鋼パンテツク技報, Vol. 34, 3 (1990), p. 8 搅拌におけるバッフル効果

Baffle Effect for Mixing



Baffle is inserted in almost every vessel for mixing a low viscosity liquid. It's reasons are to form flow pattern to be aimed, to control frow characteristic and to promote heat transfer. Flat plate baffles are generally used in agitated vessel, and there are many reports on the number of baffle and baffle width.

This paper describes baffle effect on basical mixing operation from the point of insert depth and clearance to vessel wall.

まえがき

撹拌槽におけるバッフルの役割は, 撹拌翼に比べ地味で あり払われる関心も少なくなりがちであるが, 低粘度撹拌 では大抵の場合, バッフルが挿入されている。その理由と して次の3点が挙げられる。

- (1) 撹拌目的に応じたフローパターンの形成
- (2) 撹拌動力,吐出流量,剪断速度等の流動特性値の制御
- (3) 伝熱面積の確保

また(2)の流動特性値からみたバッフルの作用は次の通り である。

- 動力数 N_p の増加
- ② 吐出循環流量係数 N_q の増加
- ③ 剪断性能 (N_p/N_q)^{1/2}·d/D の増加

バッフルの選定では、バッフルの形式、取付位置及びバ ッフル強さ(動力数 N_p を変化させる強さ)の決定を行う が、一般に用いられるバッフルは、平板バッフルが圧倒的 に多い。平板バッフルの場合、バッフル幅や本数を扱った 報告例は多数ある。しかし、挿入深さや槽壁とのスキマを 扱った報告は極めて少ない。実際の撹拌槽型反応槽では、 平板バッフルはもとよりフィンガーバッフル、D型バッフ ル、丸バッフルや伝熱管を兼用した蛇管コイル、ヘアピン コイルなど種々の形式が用いられている。

本稿では,このうち平板バッフルの挿入深さや槽壁との スキマに着目し,動力特性,混合特性など撹拌の基本的操 作に対するバッフル効果について述べる。

動力数 Np に与える影響

円筒型撹拌槽内においてバッフルの無い条件で翼を回転 させると、第1図に示すように液自由表面中央にくぼみが 生ずる。これは翼と共回りする固体的回転部(強制渦: ω =const, r < r。の領域)及びその外側に自由渦(ur= const, $\mathbf{r}_{e} < \mathbf{r} < \mathbf{r}_{2}$)が形成されるため、軸中心部と槽壁 部とで圧力差が生ずることによる。この状態では周方向の 回転流が支配的であり上下循環流は少ない。バッフルは周 方向回転流を上下循環流へ変換するために挿入され、この とき固体的回転部の領域は減少する。そして固体的回転部 の領域の減少は、動力数 N_{p} の増加となる。

ー般に挿入されるバッフルの強さはバッフル幅とバッフ ル本数で表されている。4 枚の平板バッフルでは、 $W/D \cong$ 0.13 で完全邪魔板条件となるが、通常の撹拌槽では W/D ≤ 0.1 で選定されるケースが多い。このような完全邪魔板



第1図 バッフルの無い撹拌槽内のフローパターン

Fig. 1 Flow pattern of agitated vessel under unbaffled condition [S. Nagata: Mixing (1975)]





条件以内のバッフル幅 (W/D) とバッフル本数 (n_B) に対 する 動力数 (N_p)の 関係式が 永田らにより 報告されてい 3.

$$\frac{N_{p \max} - N_{p}}{N_{p \max} - N_{p\infty}} = \{1 - 2.9(W/D)^{1.2} \cdot n_{B}\}^{2}$$

本稿ではバッフル挿入深さと槽壁とのスキマが Npに 与 える影響を調べた。その結果を第2図及び第3図に示す。

搅拌翼の比較には剪断型の代表としてタービン翼, 吐出 盾環型の代表としてファウドラー翼をそしてワイドパドル り代表としてフルゾーン翼を用いた。平板バッフルは槽径 り10%幅とし、2枚設置している。h/L=1の条件がバ ッフルを下鏡の T.L. まで挿入した場合を示している。バ ッフル 強さを W/D=(n_B×W)/(4×D) と 定義すれば, 1/L=1 の条件が W/D=0.05 のバッフル強さとなる。タ -ビン翼の場合は W/D=0.08~0.1 の組み合わせが一般的 であるがフアウドラー翼やフルゾーン翼では W/D ≤ 0.05 りバッフル強さを標準的に選定しているため、W/D≦0.05 Dバッフル強さに主眼をおいて比較した。なお,その他の 条件を次に示す。

- : \$\$400 mm ・槽径
- : 500 mm ・液深
- H/D : 1.25

・撹拌翼:タービン翼	d/D=0.4
フアウドラー翼	d/D = 0.55
フルゾーン翼	d/D = 0.6

バッフル幅,本数の変化に伴い Np が変化することはす でに述べたが、バッフル挿入深さによっても N_p が変化す ることが第2図から読み取れる。このことから Np はバッ フル幅、本数だけに依存するものではないということがい える。なお, バッフルを引き上げていくことにより Np が 低下するのは先に述べた固体的回転部 (r.) の増加による ものと考える。

第2図をもとにバッフル挿入深さと N_pの関係をまとめ ると次のようになる。



槽壁とのすきまと Nr の関係 第3図 Fig. 3 Relation of clearance to vessel wall and NP

- : $N_p \propto (h/L)^{0.44}$ ・タービン翼
- ・フアウドラー翼: $N_p \propto (h/L)^{0.31}$
- ・フルゾーン : $N_{p} \propto (h/L)^{0.50}$

一方, N_p と W/D の関係について弊社の既報 (Vol. 24, No. 1 1980) を引用すると W/D < 0.033 では

30

Ξ 20

 $\theta_{\rm M}$

÷

10

H/D = 1.25

C/D = 0.025

Pv = const

O Turbine

 Pfaudler FULLZONE

four baffles

۰

0.5

h/L [-]

第4図 バッフル挿入深さと混合時間の

Fig. 4 Relation of insert depth of baffle and mixing time

関係

・タービン翼 :
$$N_p \propto (W/D)^{0.46}$$

・フアウドラー躍: $N_p \propto (W/D)^{0.25}$

で報告されている。h/L と W/D の両者の指数を比較して みると、タービン翼はほぼ同等であるがファウドラー翼は h/L のほうが 若干大きくなっている。 これはバッフル幅 (W/D) よりバッフル挿入深さ (h/L) のほうが、Np を減 少させる固体的回転部の生成により寄与する傾向があるこ とを示している。

次に,第3図の平板バッフルの槽壁とのスキマと Npの 関係をみると, タービン翼, フアウドラー翼とも C/D> 0.2 で明かな N_p の低下が見受けられる。 これは第2図に 示される N_pの低下と同様に固体的回転部の増加によるも のと考える。第3図の平板バッフルの場合, 槽壁とのスキ マは大抵 C/D<0.1 の範囲で使用されているため、この範 囲でのスキマの選定に対しては Np の増加, 減少を特に考 慮する必要がないと考える。

混合時間に与える影響 2.

第4図にバッフル挿入深さと混合時間の関係を示す。ま た、バッフル挿入深さの変化による混合経過の比較を写真 1に示す。撹拌翼, バッフル, 液深は Np の検討に用いた 条件と同一である。なお、混合時間の決定はヨード澱粉の 呈色をチオ硫酸ナトリウムで還元脱色する脱色法による。 タービン翼、フアウドラー翼共にバッフルを引き上げす



写真1 混合経過の比較 $\mu=0.001$ Pa·s Photo. 1 Comparison in transition of mixing

ぎると混合時間の増大を招く。特に,h/L=0.05 という条件は周方向の回転流が支配的で,上下循環流が少ないというバッフル無しの流動状態に近くなっているため混合時間が増大したものと考える。次に混合時間が最も小さくなるバッフル挿入深さに着目すると,タービン翼の場合は h/L =0.5 であり,フアウドラー翼の場合は h/L=0.25 とタービン翼に比べバッフル挿入深さの小さい方に混合時間が最小となる条件が存在している。このことは回転流を強く抑制する必要が少ないというフアウドラー翼の特性を示していると考える。

一方,フルゾーン翼の混合時間はタービン翼,フアウド ラー翼とは異なりバッフルを引き上げることによってわず かではあるが増加していく傾向がある。このことからフル ゾーン翼は鏡 T.L. 付近までバッフルを挿入した方が混合 効率が良いということがいえる。

次に,第5図に槽壁とのスキマと混合時間の関係を示す。

タービン翼,ファウドラー翼共, 槽壁とバッフルのスキ マが槽径の約10%を越えると混合時間が増大する。一方, 混合時間が最小となるスキマはタービン翼とファウドラー 翼では異なる。混合時間を小さくする C/D の条件は,フ アウドラー翼の方がタービン翼よりも大きい方に存在して いる。特に,フアウドラー翼の場合 C/D=0.1 で混合時間 が最小となる。この条件をバッフルの中心位置に置き換え ると槽径の約70%にあたり,フアウドラー翼でよく組合わ されるフィンガーバッフルやD型バッフルの取付位置にほ ぼ相当している。

混合時間の短縮は吐出循環流量係数 N_q の増大によるものである。一般に、2~10回の循環で十分な混合状態が得られると言われており、この考え方を用い混合時間から各翼の N_q を推定した。次にその推定方法を示す。

混合時間 θ_{M} と撹拌翼によって生ずる吐出循環流の平均 循環時間 θ_{o} との間には次式に示すような比例関係が成立 する。

$\theta_{\rm M} = k \theta_{\rm c}$

θ。は槽内の液容量Vと吐出循環流量 Q。を用いると次式 ご表される。

$$\theta_{c} = V/Q_{c}$$

ここで $Q_{c} = N_{q}nd^{3}$
こって N_{q} は次式で与えられる。
 $N_{q} = V \cdot k/(\theta_{M} \cdot nd^{3})$

θм は次式に示す比例関係で表される。 $N_q \propto 1/(n \cdot \theta_M)$

⁻なわち混合時間が小さくなれば吐出循環流量係数 N_g は つ逆数に比例して増大することを表している。

第1表に代表的なバッフル条件での Ng の比較を示す。 :お,第1表に示す Ng は測定した混合時間から循環回数 :2回 (k=2) として算出した値である。

以上の結果より、2枚平板バッフルを使用した撹拌槽に ;ける混合時間からみた最適な挿入深さとスキマの関係は 56図となる。

すなわち効率よく混合を達成させるためには使用する撹 4翼に適したバッフル挿入深さや槽壁とのスキマが存在す っことをよく考慮し選定することが重要であると考える。

;1 表 (a) h/L による Ng の変化 able 1 (a) Change of N_a for h/L

mp.	Turbine			Pfaudler		FULLZONE	
n/L	*1	1	0.5	1	0.25	1	0.25
$\mathbf{N}_{\mathbf{q}}$	1.14	1.57	2.28	0.61	0.83	1.84	1.34

*平板バッフル4枚の場合を示す

; 1 表 (b)	C/D による Ng の変化
able 1 (b)	Change of N _q for C/D

mp.	Turbine		Pfau	ıdler	FULLZONE		
C/D	0	0.1	0	0.1	0	0.05	
$\mathbf{N}_{\mathbf{q}}$	1.46	1.75	0.61	0.81	1.35	2.16	



第5図 槽壁とのすきまと混合時間の関係

Fig. 5 Relation of clearance to vessel wall and mixing time

適用例の紹介

3.1 **固液搅拌に与える影響**

固体粒子の撹拌に関しては二つの基準がある。一方はオ フボトムの撹拌であり、もう一方は粒子の均一浮遊の撹拌 である。

第2表に各翼のバッフル挿入深さに対するオフボトムと 自由液表面近くの粒子濃度(ク)の比較を示す。なお、固体

第2表 バッフル挿入深さと粒子浮遊の比較

	Table 2	Comparison	of	h/L	for	uniform	solids	suspension
--	---------	------------	----	-----	-----	---------	--------	------------

_			- ,						-		
	In	ıp.	Turbine			o. Turbine Pfaudler		r	FULLZONE		
		h/L	n ℂR/ M⊃	Pv 〔k₩/ m³〕	¢ (-)	n (R∕ M)	Py 〔k₩/ m³〕	ф [-]	n (R/ M)	Pv ≤kW/ _m³∋	ф (—)
ş	Į	1.0	115	0.054	_	135	0.123		45	0.040	
ŧ	10	0.75	115	0.050		133	0.105		45	0.039	
r t	۵ ۲	0.5	115	0.044	_	134	0.096		45	0.039	
č	5	0.25	114	0.042	—	132	0.074		45	0.039	
	u	1.0	228	0.483	0.198	196	0.353	0.211	80	0.154	0.250
'n	nsi	0.75	229	0.489	0.223	203	0.355	0.217	87	0.157	0.288
Ϊġ	spe	0.5	239	0,485	0.291	212	0.356	0.276	93	0.153	0.30
ŝ	ns	0.25	260	0.483	0.297	222	0.354	0.284	93	0.107	0.30



6図 混合時間からみた2枚平板バッフル使用時の最適条件

ig. 6 Optimum condition on two flat baffles from point of mixing time



FULLZONE

粒子は比重1.3/粒径 600 ~ 800 µ のイオン交換樹脂を使用 し、嵩体積で30 %投入した。したがって、自由液表面近く の粒子濃度が30 %に到達すれば、一様濃度の撹拌が達成さ れていると考えることができる。

まず,オフボトムに必要な回転数に着目すると,各翼と もほぼ一定の回転数になっている。このことはオフボトム の撹拌がバッフル挿入深さに依存せず, 翼そのものの特性 に依存することを示していると考える。

一方,粒子の均一浮遊に対してはバッフル挿入深さの小 さい方が同じ動力で比較した場合,自由液表面近くの粒子 濃度を高くすることができる。すなわちバッフルを引き上 げて使用したほうが,粒子の均一浮遊に対しては良いとい う結果が得られた。

以上のことから粒子均一浮遊に対して平板バッフルを使 用する場合は,バッフル挿入深さを小さく選定する方が動 力効率が良いと考える。

3.2 表面ガス吸収性能に与える影響

第3表にバッフル挿入深さと表面ガス吸収性能の代表例の比較を示す。表面ガス吸収性能は水一空気系で, 撹拌により表面から液中に巻き込まれた空気中の酸素が水に溶解していく速度を測定し, K_La を算出した。

当社では過去の経験から、表面ガス吸収に対しては弱い バッフル条件下で積極的にボルテックスをつくり、表面更 新を多くするよう撹拌翼、バッフルを選定してきた。その 点、本データは如実にその内容を表している。特にタービ ン翼、フアウドラー翼は顕著で、h/L=1 ではほとんど表 面ガス吸収が得られないのに対して、h/L=0.25 では大幅 にその性能を向上させることができる。

フルゾーン翼の場合は、もともと表面ガス吸収にすぐれ ているためタービン翼やファウドラー翼ほどバッフルの影 響を受けないが、それでもバッフルを引き上げることによ り約4倍の K_La を得ることができる。

以上のことから表面ガス吸収に対してはボルテックスが 形成されやすい挿入深さの小さい条件を選定すべきである と考える。

むすび

一般に,バッフルについては完全邪魔板条件に近い平板 バッフルが選定されるケースが多く, 撹拌目的に応じて挿 入深さ等が検討されるのはまれである。特に,不必要にバ ッフルをきかせすぎると動力の増加と撹拌効率の低下を招 くことになる。撹拌槽の設計では平板バッフルは下部 T.L. まで挿入するのが一般的であるが,混合時間,粒子の浮遊 懸濁,ガスの表面ガス吸収いづれの場合でも程度の差こそ あれ,バッフルは引き上げて使用した方が効果的であると いう結果を得た。この点で本稿がユーザ各位のバッフル選 定のご参考になれば幸いである。

バッフルの役割として完全邪魔板条件に近いバッフル条

第3表 バッフル挿入架さと表面ガス吸収性能の比較 Table 3 Comparison of h/L for performance of gas

	absorption	from surface	9
Imp	Turbine	Pfaudler	FULL ZONE

Imp.	Turbine		Pfaudler		FULL ZONE	
h/L	Pv	К _ь а	Pv	K _L a	Pv	K _L a
1.0	1.5	4.0	1.5	3.1	0.35	14.1
0.25	1.5	88.4	1.5	94.5	0.35	54.8

件では、特に剪断特性を必要とする液滴、気泡の微細化な どに有効と考えられる。また伝熱管を兼用したバッフルで は伝熱面積の確保が優先するため、撹拌技術検討の対象に 挙げられるケースが多い。例として、蛇管コイルの場合は 中高粘度域でのコイル ~ 槽壁間の 流動がよく 問題にされ る。また、ヘアピンコイルの場合は槽内に多数設置したと きの N_p の推定が非常に困難となる。

今後は,強いバッフル条件や特殊なバッフルに着目し, 形状,配置などが撹拌特性に与える影響を解きあかしてい きたいと考えている。

〔記号説明〕

С	:槽壁とバッフルのすきま	[m]
D	:槽内径	(m)
d	:翼径	(m)
Η	:液深	(m)
h	:液表面からのバッフル挿入深さ	(m)
$K_{L}a$:ガス吸収容量係数	[1/Hr]
L	:液表面から鏡 T.L. までの高さ	[m]
n	:搅拌翼回転数	[1/s]
n_B	:バッフル枚数	[]
\mathbf{N}_{p}	:動力数	[]
$\mathbf{N}_{\mathbf{q}}$:吐出循環流量係数	[]
$\mathbf{P}_{\overline{v}}$:単位容積当たりの撹拌動力	[kW/m³]
$\mathbf{Q}_{\mathbf{c}}$:搅拌翼吐出流量	[m³/s]
u_r	:周方向流速	[m/s]
V	:槽内液容量	(m³)
W	:バッフル幅	[m]
θ_{c}	:平均循環時間	[s]
θ_{M}	:混合時間	(s)
ϕ	:自由液表面付近の粒子濃度	[]
ω	:角速度	[rad/s]

〔参考文献〕

- 1)松本,井上ら:化学工場,第26巻,第4号
- 2) 平井等:神鋼パンテツク技報 Vol. 24 No. 1 (1980), p. 1
- 3) S. Nagata: Mixing, Kodansha, Tokyo (1975)
- 4) 橋本健治:工業反応装置, 培風館 (1984)
- 5) 村上ら: 撹拌・混合・混練・分散技術集成, REALIZE INC. (1991)

耐熱衝撃性グラス

Thermal Shock Resistant Glass



Some troubles which are originated in thermal shock are rarely appeared in glass-lined equipments. Quick heating or cooling of a glass-lined area may cause a thermal stress in . glass or base metal localy and chips off the glass.

Then we considered that increasing of a residual stress in glass layer was effective for preventing those troubles, and could make sure by evaluating a relationship between residual stresses and thermal shock resistances on many conventional glasses.

On this result, we have tackled the development of a thermal-shock resistant glass and could obtain a glass with high corrosion resistance, which had a 30 degree of ΔT as superior as 9 000 glass. This paper showes the results.

まえがき

グラスライニング製反応機は、その内面に優れた耐食性 をもつグラスがライニングされているため、厳しい腐食環 竟で多用される。しかし、グラスは他の金属やセラミック スなどの耐食材料に比較して,熱の伝導率が極めて小さい。 従って反応機中の内容物の反応を制御する際,比較的大き ハエネルギーをもつ熱媒・冷媒を使って外部から加熱・冷 却が行われる。この時,希に熱衝撃あるいは熱応力によっ て写真1の写真に示すようなグラスの破壊が起こる。(a)は ジャケット側からの加熱による熱応力で、底ノズルのスエ ッジ部のグラスが割れたもので、(b)はジャケットへスチー ムを入れる際に高温のスチームが、直接グラスライニング された反応機胴部の母材側に当たったためにグラスが破壊 した状況である。本研究では、このような事故を減少させ ることと、反応機の操作性の向上、反応プロセスの時間短 縮を目的にして,より大きい温度差に耐え得るグラスの開 発に取り組んだ。その結果一応の成果を得たので次に報告 する。

|. 考え方

|.1 熱応力と熱衝撃

(a) Bottom nozzle



写 真 1 熱衝骤及び熱応力による事故例 Photo. 1 Examples of trouble by thermal shock and thermal stress

一般に、物体が急激な加熱または冷却によって、その中 に激しい温度変化を生じ、衝撃的な熱応力を受ける現象が 熱衝撃といわれている1)。その意味ではいずれの場合も「熱 応力」と表現すべきかもしれない。グラスライニングにお いては、急冷・急加熱を受けた際、その部分のグラスある いは母材に過大な応力が働き、グラスが破壊する場合を熱 衝撃、グラスライニング製機器が冷却あるいは加熱された 時、構造的に応力が集中した部分のグラスが破壊する場合 を熱応力と呼んでいるように思われる。すなわち熱衝撃は 材料自体の熱膨脹特性に依存するのに対し、熱応力は構造 に支配されるといえよう。写真1の(a)の写真で示される破 壊は、ジャケット側からスチームで加熱し、ノズルスエッ ジ部に応力が集中し母材が降伏した結果でこれを熱応力, (b)の写真で示される破壊は、母材に直接高温のスチームが 当たり、その時の熱衝撃により母材が降伏し、裏面のグラ スが破壊された,あるいは母材が受けた熱衝撃がグラスと 母材の境界近傍に大きい温度差をつくり、その結果過度の 応力が生じたためと考えている。これらの他に、グラスが 熱衝撃により破壊するケースとして, グラス表面が直接急 冷・急加熱され、その部分のグラス内部にグラスの収縮に



(b) Vessel wall



第1図 残留圧縮応力と耐熱衝撃性の関係 Fig. 1 Dependence of thermal shock resistance on residual compressive stress

よる引張り応力が発生し破壊することもある。本研究はグ ラスの開発により,前述したような熱衝撃に対する耐性を 向上させることを目的とした。

1.2 耐熱衝撃性を律するグラスの性質

グラス自体の引張り強度は約80 MPa で、圧縮強度は約 800 MPa であり 引張り強度は 圧縮強度に対し 十分の一と 弱い。従って、熱衝撃を受けた場合においても多くはグラ スに引張り応力が働いた時に破壊する。一般に鋼にライニ ングされた グラスには約 150 MPa の残留圧縮応力が 存在 しており、単純にはグラス自体の引張り強度と、この残留 圧縮応力を加えた230 MPaの引張り応力が熱衝撃により 働いた時、グラスが破壊することになる。残留圧縮応力が 大きいほど熱衝撃に対して強いことが予想される。そこで 従来のライニンググラスの残留圧縮応力と、耐熱衝撃性の 関係を第1図にまとめた。 横軸にグラス中の 残留圧縮応 力,縦軸に耐熱衝撃性としてグラスが破壊するときの温度 差を、それぞれ増減で示した。グラスの破壊はクラックの みの場合を○で、剥離まで至った場合を●で表した。この 結果から予想通り耐熱衝撃性と残留圧縮応力に相関を見出 だすことができた。すなわち残留圧縮応力の増大は耐熱衝 撃性を向上させるということである。

以上のことから,耐熱衝撃性のグラスを開発するために は,グラスの残留圧縮応力を増大させることが一方法であ ると推測される。

1.3 残留圧縮応力と熱膨脹特性の関係

鋼とグラスの熱収縮特性を第2図に示す。横軸が温度, 縦軸が伸びで、図中 Sp はグラスの軟化温度, Tg はグラ スの転移温度, Pは焼成され室温(R.T.)まで冷却された 時に生ずる鋼とグラスの収縮量の差で,残留圧縮応力を律 するものである。この図から残留圧縮応力すなわちPを増 大させるには、次の方法が考えられる。

- (1) グラスの膨脹率を小さくする。
- (2) 転移温度を大きくする。
- (3) 軟化温度を大きくする。
- (4) 転移点と軟化点間の膨脹率を小さくする。



第2図 鋼とグラスの熱収縮特性 Fig. 2 Thermal contraction properties of steel and glass



第3図 熱膨張係数と残留圧縮応力の関係

Fig. 3 Relation between thermal expansion coefficient and value of residual stress

この中で特に(1)の膨脹率については、成書等で経験則から成る加成式、膨脹係数因子が明らかにされており²⁰,その調整はし易い。そこで従来のライニンググラスの残留圧縮応力の熱膨脹係数依存性を第3図にまとめた。この図から熱膨脹係数を小さくすることが残留圧縮応力増大を可能にする一因子であることがうかがえる。

2. 実験方法

2.1 グラスの試作

加成式, 膨脹係数因子等を参考にして, SiO₂, Al₂O₃等 熱膨脹係数を小さくする成分を数種類選び, それぞれ添加 比率を変えて約30種類の化学組成を決めた。これらの化学 組成になるようにグラス原料を配合・混合し, それをるつ ぼに入れて炉内で溶解し試作グラスを得た。溶解し冷却さ れたグラスはミル添加物と一緒にミルで粉砕・混合し釉薬 となり, 各種テストに供された。

2. 2 実験室的評価試験

全ての試作グラスについて熱膨脹係数,残留圧縮応力等



r 真 2 実機を使った熱衝撃実験 hoto. 2 Thermal shock test by using an actual vessel



写真 4 実機の熱衝撃試験結果 Photo. 4 Result of thermal shock test on an actual vessel



写真3 テストピースの熱衝撃試験結果 Photo.3 Result of thermal shock test on specimens

)測定及び耐食試験,熱衝撃試験等を行った。これらの測 き,試験及びそれに必要な試片は全て社内標準に準じて行 っれた。

3 実機による評価実験

試験室的評価試験を繰り返し,初期の目的を達成できる :予想される試作グラスを選び,実機による評価実験を行 ,た。主な実験項目について次に述べる。

, 3.1 焼成実験

新しいグラスが良好な状態で実機にライニングできるか か、あるいはどのような焼成条件が必要か確認すること :目的とする。具体的には数種類のテスト用缶体に施釉・ む成を施し、施釉時の釉薬特性及び焼成時のライニング特 とを調べ、さらには最適焼成条件の把握等を行った。

3.2 残留応力の測定

100 ℓ のテスト用缶体に 試作グラスを最適条件でライニ /グし,完成させた後にそのグラス中の残留応力をチップ リムーバー法で数箇所測定した。

2. 3. 3 熱衝撃実験

試験室での試片による熱衝撃試験以外に100 ℓ のテスト 用缶体を用いても熱衝撃実験を行った。写真2に示すよう に、炉内で所定の温度に加熱した後炉外に出し、グラス面 を水で急冷する方法をとった。缶体にライニングされたグ ラスにクラックが生じたときの炉温と水温の差を 4T とし て評価した。

結果及び考察

数多くのグラスを試作した結果,当初の目標を満足させ るグラスが得られた(以下,「耐熱衝撃性グラス」と呼ぶ) ので,次に主としてそのグラスの試験結果と考察を述べる。

3.1 耐熱衝撃性グラスの熱衝撃試験結果

試片による熱衝撃試験の結果を写真3に示す。各 dT に ついて試片 2 枚づつ写真にしてまとめた。この写真から最 初にクラックが発生する dT は260°C で、剥離は 290°C であることが分かる。ちなみに現在当社標準の高耐食性グ ラス9000はクラックが210°C、剥離が 230°C であり、試 片の場合は耐熱衝撃性グラスが約50°C 上回る耐熱衝撃性 を有することになる。

クラック 及び 剥離いずれも 試片の周囲から 発生してい る。このことは、グラスに働いた引張り応力が、エッジ効 果で強度の低下している部分からクラックに至らせしめた ものと考えられる。

次に 100 ℓ テスト用缶体にグラス9000と耐熱衝撃性グラ スをライニングし、それぞれ同一条件で熱衝撃試験を行っ た。その結果、9000グラスは dT=190 °C、耐熱衝撃性グ ラスは dT=220 °C でそれぞれクラックが発生した。クラ ックの状況を写真 4 に示す。どちらのグラスもこの写真に





第4図 耐熱衝撃性グラスのもつ残留応力特性 Fig. 4 Characteristic of residual stress of thermal shock resistant glass

表われているように、クラックが底ノズルスエッジ部から 放射状に発生しているのが特長である。

テスト缶体を使った結果が試片の結果に比べ, dT が 20 ~40 °C 低くなった。これはテスト缶体が試片と異なり構 造物であるため,熱衝撃による応力が部分的(底ノズルス エッジ)に集中した結果と考えている。

3.2 耐熱衝撃性グラスの残留応力特性

熱膨脹率等の検討の結果得られた耐熱衝撃性グラスの残 留応力特性を,従来の標準グラスと合わせて第4図に示し た。この図はグラスライニングを加熱・昇温したときのグ ラス中の残留応力の変化を表したもので,横軸は温度,縦 軸はグラス中の残留応力である。耐熱衝撃性グラスは3100

(旧標準グラス)及び9000グラスに比べ,室温での残留圧 縮応力が大きく耐熱衝撃性の向上を裏付けている。また圧 縮応力から引張り応力に変わる温度(図中「A」)が約30 °C上昇しており,他のグラスに比べより高温まで使用で きる。引張り応力が極大の部分B点(Max. tension⁴⁾)で は9000グラスよりも大きいが,旧標準グラス3100と同等の

100 ℓ の実機における チップリムーバー法による残留圧 縮応力の測定結果では、それぞれ胴部において9000グラス が約 150 MPa, 耐熱衝撃性 グラスが 約 180 MPa であっ た。両グラスの引張り強度を80 MPaとすると、前者は230 MPa, 後者は260 MPa の応力が働いた時に破壊する。

ここで、 $\sigma=応力$, $\mathbf{E}=ヤング率$, $\mu=ポアソン比$, $\alpha=$ 線膨脹係数とすると下式が成立する。

$$\sigma = \mathbf{E}\alpha \Delta \mathbf{T} / (1 - \mu) \tag{1}$$

いま,両グラスについて $E=8 \times 10^4$ MPa, $\mu=0.24$, $\alpha=9 \times 10^{-6}$, °C として,それぞれ破壊させるに必要な dT を (1)式から算出すると,9000 グラスは 243 °C, 耐熱衝撃性 グラスは 274 °C となる。この差は 31 °C であり,実機の 熱衝撃試験結果の30 °C の差と良く一致する。但しこの計 算は理想状態を仮定しており,構造的制約を受ける実機の 実験結果に比べ, Tの絶対値が異なるのはいうまでもな い。

3.3 実機の使用温度範囲

以上に述べた熱衝撃実験及び残留圧縮応力測定の結果から、標準グラス9000に比べ *A*T が30°C 向上した耐熱衝撃 性グラスが、どのような温度範囲で使用できるか**第5**図を 用いて考察する。この**第5**図はテスト缶体での熱衝撃実験 の結果に基づき、実際にグラスライニング機器を使用する 場合の許容温度範囲を示したものであり、安全率が含まれ ていることを考慮されたい。

第5図(a)はジャケット側から加熱あるいは冷却された缶 内に内容物を仕込む際の,内容物と缶体の許容温度を表し たグラフである。

図中黒塗りされた範囲は内容物より缶体の方の温度が低いときの許容温度を示している。例えば、190°Cの内容物を投入するときは、缶体の温度を50°C以上にしておかなければならない。あるいは50°Cの缶体に内容物を投入するときは、内容物の温度を190°C以下にしなければならない。

育 1 表 耐熱衝撃性グラスの耐食性 [able 1 Corrosion resistance of thermal shock resistant glass

		Thermal shock resistant glass	9000 glass
(ISO, mm/y)	20%HCl H2O	0.04 0.01	0. 04 0. 01
	1N-NaOH	0.28	0.20

図中網掛けで印された範囲は内容物より缶体の温度が高 ハときの許容温度を示している。例えば、170°Cの缶体 こ内容物を投入するときは、内容物の温度を40°C以上に しなければならない。あるいは内容物の温度が40°Cのと きは、缶体の温度を170°C以下にしておかなければなら ない。

以上は9000グラスの使用温度範囲であり,耐熱衝撃性グ ラスの場合は,図中斜線で示された分だけ使用温度範囲が 広がる。すなわち,例えば内容物の温度が40°Cの時,缶 体の温度は9000グラスであれば170°C以下であるべきと ころ,耐熱衝撃性グラスであれば,30°C上回る200°C以 下で良い。逆に缶体より内容物の温度が高い場合は,グラ スに圧縮応力が加わることになり,残留圧縮応力を高めた 耐熱衝撃性グラスのメリットは無いと考えられる。

第5図(b)は缶内に内容物が仕込まれている状態のジャケット内に,熱媒(スチーム)あるいは冷媒を入れる時の, 内容物とスチームあるいは冷媒の許容温度を表している。

図中黒塗りは、スチームにより内容物を加熱する場合、 網掛けは冷媒により冷却する場合に許容されるそれぞれの 温度範囲を示している。この条件の場合も(a)図と同様に耐 熱衝撃性グラスであれば 斜線の分、許容温度範囲が 広が る。

ここで考慮しなければならないことは「熱応力」であ る。ジャケットから高温加熱する場合,冒頭で述べたよう に,底ノズルスエッジ部等構造的に熱応力が集中し,鋼が 降伏する場合がある。設計の段階で十分配慮しておく必要 がある。

3. 4 耐熱衝撃性グラスのその他の性能

主に耐食材料として用いられるライニンググラスには, いくつかの性能が必要になる。本耐熱衝撃性グラスも例外 ではない。第1表にその他の性能として耐食性をまとめた。

まず耐食性は I S O 規格に準じ行われた試験結果で, グ ラス 9000 に比較して 若干耐アルカリ性が低下するが, 耐 酸,耐水性は同等であった。グラスライニングが高温で使 用されるケースは,酸性あるいは中性の内容物であると理 解しており,使用上はグラス9000に匹敵する耐食性と考え て良い。

但し、本耐熱衝撃性グラスは残留圧縮応力を増大させた 結果、凸R部のグラス剥離、焼成温度の上昇、焼成過程の グラスのクラック(ヘヤーライン)等により、施工面で多 大の困難を伴うことがテスト缶体による焼成実験から明ら かになった。これらの問題点を解決し総合的品質を保証す るためには本グラス固有の新しい施釉技術、焼成技術及び 新鋭化された当社工場設備を駆使することが必要不可欠で ある。

4. 総括

グラスライニングの耐熱衝撃性を向上させる目的で,新 しいライニンググラスの開発に取り組んだ結果,次の結論 を得た。

- (1) 当社標準グラス9000に比べ、実機ベースで *d*T=30
 °C 上回る耐熱衝撃性グラスを開発した。
- (2) 耐熱衝撃性グラスの 耐食性は グラス 9000 に匹敵する。
- (3) グラス中の残留圧縮応力とそのグラスの耐熱衝撃 性,及び残留圧縮応力と熱膨脹係数に相関があることをそれぞれ確認した。

むすび

この度,新しい機能を持つライニンググラスとして,耐 熱衝撃性グラスを開発することができた。この新しいグラ スが,多くのグラスライニングユーザにご使用頂ぎ,良い 評価が頂けることを期待するとともに,さらに精進し現状 グラスの性能向上,新しいニーズに応えられるグラスの開 発を目指す所存である。

〔参考文献〕

- 1) 鵜戸口:日本機械学会誌,第65巻,第525号(1962) P.1455
- 2) 「ガラスハンドブック」:朝倉書店(1988) P.694
- 3) J I S R4201
- 4) 沢田雅光:神鋼フアウドラー技報, Vol. 29. No. 2 (1985)

p. 14

薄膜蒸留装置ワイプレンを使った システム紹介

Introduction of Systems on Wiprene (Wiped Film Evaporator)



WFE (Wiped Film Evaporator), whose term of endearment is "Wiprene", has been in wide use as a continuous thin film evaporator in the field of product separation or product purification. It is important to select suitable combination of the "Wiprene" with the peripheral equipment depending on various liquids to be processed.

The following are explanation of function and criterion for selection of the "Wiprene" and example of its systemized application on a commercial scale.

まえがき

薄膜蒸留装置 WFE (Wiped Film Evaporator) は愛称 "ワイプレン (Wiprene)"のネーミングを新たにした。

ワイプレンは連続式薄膜蒸留装置として分離精製分野に 広く使用されているが,処理目的,取扱物質の性状は多岐 にわたり,各々の計画に当たってはワイプレンのハード機 能及び周辺設備とのシステム構成を適切に選定することが 重要である。ここではワイプレンの機能および選定基準を 説明し,実設備のシステム事例を紹介する。

1. ワイプレンの構造および特長

薄膜蒸留装置ワイプレンの構造を第1図に示す。

- 1) 撹拌型, 立型であり, ワイパーにより処理液を薄膜に 形成する。
 - (1) 高粘度物質でも伝熱性能が良好である。
 - (2) 液平均滞留時間が秒単位で非常に短く,熱影響を受

け易い物質の処理に最適である。

- (3) 少ない流量でもドライアップし難い。
- (4) ローター回転数は低速でその目的を達することができ,所要動力は小さくてすむ。
- (5) 構造はシンプルであり、分解組立が容易である。
- 2) 蒸発室にコンデンサーを内蔵できる。

С

- (1) 高真空操作が可能であり,沸点の高い物質の蒸留を も行うことができる。
- (2) 装置全体をコンパクトに設備することができる。
- 3) ローターにミストセパレーターを内蔵できる。
- (1) 操作条件,液物性によって蒸発部で飛沫同伴し易い 場合に対処できる。
- (2) ミストセパレーターはチャンネル型、シェブロン型、ルーバー型の3種類があり、物性によって使い分ける。

1 Feed inlet

Wipers

Scraper

& inlet

2 3

(4)

(5)

6) (7)

(8)

ത

(10)

സ

(12)

10

Distributor plate

Evaporator wall

Internal condenser

Residue outlet

Vacuum outlet

Distillate outlet

Vapor outlet

Entrainment separator

Cooling water outlet



Low vacuum wiped film evaporator

第1図 薄膜蒸留装置ワイプレン

Fig. 1 Schematics of wiped film evaporator

High vacuum wiped film evaporator (Molecular still)

- 4) ワイパーはA型とB型の2種類がある。
- (1) A型はワイパーがワイパーリテーナーにフリーで挿 入され、ローター回転による遠心力で面圧が決定され るものであり、標準装備形式である。
- (2) B型はワイパーがスプリング板に保持され、機械的 に面圧調整ができる。高粘度物質、付着生成物質、固 形物が発生する物質の処理あるいはエロージョン・コ ロージョン現象の可能性がある物質の処理等に適用される。

. 蒸留装置としての機能

一般に蒸発と蒸留を分けて言い表されているが,蒸発は 下揮発成分を含む溶液を加熱して単一成分が気化すること といい,蒸留は2成分または多成分系の原液においていず 1の成分も蒸気圧を有して蒸発する場合をいう。

単蒸留の基本形として第2図に回分式単蒸留装置を第3 引に連続式単蒸留装置を示す。

第2図の回分式単蒸留は微分蒸留であり,液が少しずつ 頁次に気化し,発生蒸気全ての平均組成は残液組成と平衡 툇係にならない。

第3図の連続式単蒸留は積分蒸留であり,発生した全蒸 気の組成は残った液組成と平衡関係にある。



32 図 回分式単蒸留

'ig. 2 Batch simple distillation

ワイプレンは蒸発,蒸留あるいは精留塔リボイラー等の 用途に使用されているが,蒸留形態として見た場合**第3図** の連続式単蒸留に近いものである。

時には**第2**図のバッチ操作で蒸留されたものとワイプレンで蒸留した蒸気組成及び残液組成が異なるとの指摘を受けることもあるが、これは蒸留形態の差異によって生じる現象である。

ワイプレンは加熱蒸発機構と共にコンデンサーを内蔵す ることができ、またローターにミストセパレーターを付属 することができるので,第3図に示す予熱・加熱器,蒸発 器,ミストセパレーター,コンデンサーを一体とした機能 を果たすことが可能である。

次項よりワイプレンを使ったシステム例を紹介する。

高真空蒸留システム

脂肪酸系, 医薬品あるいは液状ポリマーなど高分子量物 質の蒸留では, 沸点が高いこと及び熱変質の関係から高真 空操作が 必要になる。 医薬品物質では 沸点の 関係もある が,特に熱変質の問題より高真空, 低温操作を必要とする 場合が多い。

第4図に高真空蒸留のシステム例を示す。実施例の操作 真空度は脂肪酸系で 0.1~0.2 Torr (13~27 Pa), 医薬品, 液状ポリマーで 0.02 ~ 0.05 Torr (2.7~6.7 Pa) 等がある。



第3図 連続式単蒸留

Fig. 3 Continuous simple distillation



3.1 ワイプレン形式

加熱蒸発面とコンデンサー冷却面を近接させた構造であ る高真空用を適用する。蒸発面と冷却面が近接しているの で蒸発ベーパーの圧力損失を最小にして高真空を維持する ことができ、工業規模の処理が可能となる。

ワイプレンは**第1 図**に示すように低真空用と高真空用が あり,操作真空度 1.0 Torr (133 Pa)を境界として使い分 けることにしている。しかし,低真空用内部コンデンサー 型であってもベーパー流量と排気系の関係で 0.1 Torr (13 Pa)の操作が行われている例はある。

3.2 脱ガス処理

高真空操作を行うためには ワイプレン 前段工程に おい て,処理原液はできる限り脱ガス,低沸点成分の除去を行 っておく必要がある。しかし前段工程の脱ガス条件は十分 でない場合が多く,蒸留工程においてワイプレン上流側に も第4図のように脱ガス装置 (Deaerator)を設備するこ とが一般的である。

注意すべき点は予熱・蒸留中に発生するノンコンガスであり、当社が実測した例では脂肪酸系物質の場合 1.5 N-m^3 /liq.m³であり、この3倍を超える物質もある。また可塑剤では 250%のガス容積 (2.5 N-m^3 /liq.m³) であるとの報告がある。

ここで、大気圧下でのガス容積 $1 N-m^3$ は真空 0.1 Torr (13 Pa) 下では 7 600 m³ になり、 0.02 Torr (2.7 Pa) では これの 5 倍になることを考えれば脱ガスの重要性が理解で きる。また、低沸ガスが残留する液では薄膜形成が阻害さ れて伝熱性能に影響する可能性がある。

脱ガス装置は一般に蒸留真空度の10倍程度の低真空で操作し,液残存ガス及び予熱分解ガスをできるだけ除去する機能を果たす。

実施例の脱ガス器真空度は蒸留真空度 0.1 Torr (13 Pa) に対して 1 Torr (133 Pa), 0.02~0.05 Torr (2.7~6.7 Pa) に対して 0.1 Torr (13 Pa) であった。

3.3 高真空排気系

蒸留における発生ガス量,系内洩れ空気量を,圧力損失 を許容内でスムーズに排出し,高真空を維持するために は,大容量の高真空排気装置と蒸留器内の十分な空間及び 排気接続管が必要になる。

実施した1例 <操作真空度 0.02~0.05 Torr (2.7~6.7 Pa)> を挙げると次の仕様である。

脱ガス器用高真空排気装置:ルーツ式真空ポンプ2段+ エアーエジェクター付水封式真空ポンプ

抽気量 1500 m³/h at 0.1 Torr (13 Pa)

蒸留器用高真空排気装置:ルーツ式真空ポンプ2段+油 回転真空ポンプ

抽気量 7000 m³/h at 0.01 Torr (1.3 Pa)

4. 濃縮システム

単蒸留では低沸組成リッチの留出分と無機物あるいは高 沸組成リッチの濃縮残留液に分離される。処理目的として は濃縮残留液が製品あるいは目的物となる場合,留出液が 製品あるいは目的物となる場合,両者とも有効目的物とな る場合など種々あるが,ここでは濃縮用途について紹介す る。第5図に3段濃縮のシステム例を示す。

実施例は低分子量ポリマー中の溶剤含量 80 WT%を 100 ppm 以下に 濃縮することが処理目的であるが, 蒸発分離 された溶剤も回収再利用される。原料中に含まれる溶剤の 蒸発率は99.99%である。

- 4. 1 ワイプレン操作条件
- 4. 1. 1 濃縮度(溶剤蒸発率),操作圧力
- 1)#1ワイプレン:ポリマー濃度 IN 20WT% → OUT
 95WT%(溶剤蒸発率93.8%). 操作圧力 100 Torr (1.33×104 Pa)
- 2) #2ワイプレン:ポリマー濃度 IN 95 WT% → OUT
 99.7 WT% (溶剤蒸発率94.0%) 操作圧力 10 Torr (1.33×10³ Pa)
- 3) #3 ワイプレン:ポリマー濃度 IN 99.7 WT%→OUT
 99.99 WT%(溶剤蒸発率 96.7%) 操作圧力 1 Torr (1.33×10² Pa)



第5図 濃縮システム Fig. 5 Concentration system



第6図 精留システム

- Fig. 6 Rectification system
- 4.1.2 加熱温度
- ポリマー熱変質の関係で加熱温度が限定される。
- 4.1.3 沸点上昇

ポリマー 濃度が高くなるにつれて沸点は上昇し,高沸ポ リマーの共沸が無視できなくなる。

- 4.2 ワイプレン形式
- 1) #1 ワイプレン: 低真空用外部 コンデンサー型, A型 ワイパー付

処理液は溶剤組成が多く,ポリマーの熱変質は起り難 いので,ワイパーはA型を選定している。

2) #2 ワイプレン: 低真空用外部 コンデンサー型, B型 ワイパー付

処理液の溶剤組成が少なくなるとポリマー熱変質が生 じ易くなり,付着滞留分の経時的重合が問題となるので ワイパーはB型を選定している。

3) #3ワイプレン: 低真空用内部 コンデンサー型, B型 ワイパー付

内部コンデンサー型選定理由は高真空操作と脱揮効率 向上にある。

4.3 フラッシュタンク

ワイプレンの上流側にはそれぞれフラッシュタンクを設 けている。過熱原液がワイプレンにフィードされると,ワ イプレンフィード部でフラッシュが起こり原液の飛散が生 じる。フラッシュ発生は濃縮液側に対しては原液がショー トパスして未濃縮の原因となり,留分側に対しては蒸発ベ ーパーへ原液が飛散してエントレの原因となる。フラッシ ュタンクは過熱原液をワイプレン操作圧力に対して飽和液 とするものであり,脱揮用途では特に注意する必要があ る。

4. 4 濃縮液保温

ワイプレン加熱部で所定の濃度に濃縮されたとしても, その下流側の液排出部で温度降下があると蒸発ベーバーの 再凝縮が起こって濃縮未達成となる場合がある。この様な 場合には濃縮液排出配管で液封を行い,その部分の保温を 十分に行うことが効果的である。

4.5 高沸物の共沸

高沸点成分も蒸気圧を有しており,気液の平衡関係で蒸発する。比揮発度が大で低沸点成分の多い領域における蒸留では高沸点成分蒸発が無視できるとしても,濃縮度が上



第7図 加圧運転システム Fig. 7 Pressure distillation system

がり低沸点成分が少なくなると高沸点成分の蒸発組成が顕 著となり無視できなくなる。

低沸点成分の回収で純度が問題になる場合には回収率の 関係から真空度,操作温度の選定に注意が必要であり,精 留装置を付設することも必要になる。

4.6 真空排気装置

実施例では#1及び#2は油回転真空ポンプ,#3はルー ツ真空ポンプ1段+油回転真空ポンプとし,個別に真空度 制御を行っている。

各処理段の 真空度は 各濃縮度, ベーパー凝縮回収の 目 的, 熱変質の制限, ユーティリティー設備条件などから決 定されている。相互干渉のないように各処理段毎独立の真 空排気装置を配備することが一般である。

5. 精留システム

第6図にワイプレンを精留塔用リボイラーとして使用したシステム例を示す。

処理物質に熱影響を及ぼさないというワイプレンの特長 を活かしたものである。ワイプレンは低真空用外部コンデ ンサー型が適用される。

6. 加圧運転システム

第7図に加圧運転システム例を示す。

濃縮液の融点あるいは流動点が高く,蒸発成分の蒸発温 度の関係で加圧運転とする必要がある場合,また,前後の プロセスの関係上,加圧下で操作せざるを得ない場合に採 用される。

7. 脱臭システム

食品, 化成品関係では脱臭が重要な工程となる場合がある。第8図にスチームストリッピングによる脱臭システム 例を示す。

臭気成分の除去にはいろいろな方式があるが,単に通常 の真空蒸留では目的を達成できず,処理液とスチームとの 向流接触が非常に有効に作用する場合がある。

ワイプレンはワイパー作用により処理液を加熱面に均一 な液膜を形成するとともに液膜は撹拌されており,本体内 にスチーム排出口を兼ねた内筒を挿入する構造として,効 率の良い向流接触機能を発揮できる。



8. 廃油処理システム

第9図に廃油の処理システム例を示す。

廃油原液は水分を 97 WT% 含んでおり、 ワイプレンに より水分を蒸発分離し、凝縮水は放流する。一方脱水され た濃縮オイルは廃液熱分解装置の燃料として燃焼され、こ の燃焼熱を利用した廃熱ボイラーで発生するスチームはワ イプレンの加熱源として使用される。本例は遺棄できない 廃油の省エネ処理システムである。

t: す び

ワイプレンの 基本的な 用途例を 紹介したが、 簡単な装 置, システムであっても いろいろな 応用分野, 用途があ

Fig. 9 Concentration system of waste oil

り、多方面にご使用いただいている。目的とする性能を満 足する為にはワイプレンの単体機能を理解の上で機種選定 することは当然必要であるが,周辺のエンジニアリングに 十分配慮することが重要であると痛感する。

姉妹機である EXEVA (高粘度液用薄膜蒸留装置)と共 に新分野,新用途に向い,エンジニアリングサービスを充 実させ、 皆様の ご要望に お応えして いきたいと考えてい る。

〔参考文献〕

- 1)編集者 平田光穂,頼実正弘:蒸留工学ハンドブック,
- (1966),朝倉書店

2) 著者 河東準,岡田功:新版 蒸留の理論と計算,工学図書

ヤコブソンミルの紹介

Introduction of Jacobson Mill



Jacobson Mill is one of air swept pulverizers and a combination grinder/classifier, designed to handle size reduction applications in the medium to ultrafine particle size range. It combines two unique operating principles to achieve maximum efficiency. First, a controlled air stream and centrifugal force are used as the continuous milling, classifying and conveying medium. Second, particle size reduction is achieved by simultaneous three-way-action impact, shear, and air-turbulence attrition.

With a reputation for ease of operation, low cost maintenance, simplicity of clean-out, and durability, the Jacobson Mill is found uses in a wide variety of industries.

:えがき

粉砕はあらゆる工業分野において不可欠の単位操作とし 定着している。その中で各分野の重要な開発目標となっ いる微粉砕の分野が注目されて久しい。微粉粒子の製造 ついては粉砕機による機械的単位操作のみでなく,化学 I,物理的方法によってなされており,このうちサブミク ン粒子製造の主流となっているのは,液相沈殿法や気相



hoto. 1 Jacobson Mill

析出法による析出法である。しかしこのような方法により 微粉が生成されても、それら微粉は凝集力が強く、その分 散のためにも微粉砕機が使用されている¹⁾。

種々の粉砕機の中で微粉砕機として分類されるのはボー ルミル(振動ミルや遊星ミルを含む広義の意味で), 高速 回転式衝撃粉砕機, ジェットミル, 媒体撹拌式粉砕機であ る。弊社にても湿式微粉砕及び分散機としてアニュラー型 媒体撹拌タイプのコボール・ミル, 湿式及び乾式のスエコ 振動ミルを上市し各業界から好評をもって迎えられてい る。しかしこれらはすべて粉砕メディアの作用により微粉 砕を行うものであり, 主として湿式で利用されている微粉 砕機である²⁾。

ここに紹介する乾式粉砕機ヤコブソン・ミル(写真1) は、アメリカ JACOBSON 社にて開発されたものであり、 エアスエプト方式の軸流型高速回転式衝撃粉砕機として分 類されるものである。分級機構を内蔵し、乾燥操作をも同 時に行うことが可能であるため、汎用性に富み多くの業界 で使用実績を有している。

1. ヤコブソンミルの機構

ヤフプソンミルはその前身である SCHUTZ-O'NEILL 社により開発され,その後改良が加えられたミルである。 粉砕機内に空気を取り入れ,破砕物をその空気流にのせて 輸送しながら機外へ取り出すエアスエプト方式を採用し, 分級板を内蔵することにより砕生品を分級している。 ヤコプソンミルの機構について**第1図**により説明する。

Fig. 1 Schematic Jacobson Mill

粉砕機入口①より砕料を供給フィーダもしくはロータリー バルブ等により供給する。粉砕室の中心には主軸②が通っ ており,主軸にはランナ⑥のついた複数の回転板③と有孔 分級板④とが取付けられている。第1列目の回転板には衝 撃プレート⑤が回転板の中ほどに複数個配列されており, ミルに入った砕料はこの衝撃プレートにより粗砕される。 粗砕された砕料は遠心力の作用にて回転板の円周方向に進 み,粉砕室⑦の内壁に取付けられたライナ⑧とランナとの すき間およびライナとライナとの間隙で剪断力を受け粉砕 される。さらに高速回転するランナにより生じる後流の渦 中で粒子同士の摩砕による粉砕が進行する。

ライナは軸方向に歯型状の多数の溝を有し粉砕効果を高 める働きをしている。このライナはランナとのすき間を調 節出来るように円周一カ所にスリットが切ってあり,ライ ナ摩耗時の取り替えが出来る構造となっている。粉砕され た粒子は気流にのって前方に進み,分級板にて遠心力の作 用で分離され,微粉は分級板に設けられた孔を通りミル出 口⑪から排出され,その下流に設置されたバグフィルタな どにより製品として捕集される。 粗粉は 微粉から 分離さ れ,粉砕室先端付近の開口部から循環路⑨を通り入り口側 ヘリサイクルされ,再び粉砕される。粉砕機内への空気は 排風ファンによって,ミル入口および二次空気取り入れ口 ⑩より吸引される。

ランナの形状や分級板の型式を変化させることにより砕 生物の粒度をコントロールすることが出来るが、粒度やそ の分布はライナとランナとのすき間、ランナの回転速度、

ミル内での砕料保有率などによっても異なる。

ヤコブソンミルは、衝撃力だけでなく、微粉砕に必要な 剪断力、摩砕力が強く作用するため、幅広く微粉砕機とし て使用することが出来るが、大きさで6mm程度、硬度で はモース硬度3以下の砕料に最適の微粉砕機である。粉砕 により砕料は発熱するが、吸引空気により冷却される。し かし熱敏感性物質や低温脆化物質の粉砕の場合には低温ガ スを使用し、より低い温度で粉砕することも出来る。さら に加熱ドライエアを使用することにより、粉砕と同時に乾 燥を行うことも可能である。

- 2. ヤコブソンミルの特長
 - ヤコブソンミルの特長として次の点があげられる。
 - (1) 気流と遠心力の調節により、粉砕、分級、排出を連続的に行い、安定した砕生品を得る事が出来る。
 - (2) 衝撃力,剪断力,摩砕力の同時作用により 5 µm 以 下に微粉砕出来る。
 - (3) 加熱ガスの使用により乾燥操作も同時に可能
 - (4) 内部分級機構及び再粉砕機構により,シャープで均 一な砕生品が得られる。
 - (5) ランナ及び分級板の交換により,幅広い原料粒度, 粉砕粒度に対応できる。
 - (6) ミル出口側のハウジングを開けることにより, 簡単 に内部が洗浄出来るなどメンテナンスが容易である。
 - (7) ミル入り口から出口までサニタリー仕様に対応する ことが可能(オプション)

3. 粉砕システム

最も一般的なシステムはヤコブソンミルと製品捕集装置 を組み合わせたものである。第2図に代表例を示すよう に、原料供給装置、ヤコブソンミル、バグフィルタ及びそ れに付属するロータリーバルブ、排風ファンの組み合わせ となる(写真2参照)。製品の粒度分布を厳しく規制する

Fig. 3 Grinding and drying

必要がある場合にはヤコブソンミルとバグフィルタの中間 に分級機を設置する。また、分級機を設置する場合、閉回 路粉砕システムを組み、微粉を製品として下流側のバグフ ィルタで捕集し、粗粉をミル入り口側に戻すことにより、 粉砕効率を高めることも出来る。

第3図は粉砕・乾燥プロセスの場合で、系中にエアヒー タを入れ、加熱ガスをミルに吸引し、砕料を粉砕すると同 時に乾燥し、バグフィルタで捕集する。ファンからの排気 は熱交換機を通し系外へ排出する。この排気と熱交換され たフレッシュエアはヒータによりさらに所定の温度まで上 げられミルに入る。

4. ヤコブソンミルの仕様

ヤコブソンミルはモータ動力15 HPの小型機から600 HP の大型機まで6 機種あり、型式及び仕様を**第1表**に示す。

5. ヤコブソンミルの適用例

食品,化学品,セラミックスなどに多数の実績があり, その内の数例を示す。

- (1) 砂糖
 [目的] 粒状物を325メッシュ以下
 [結果] 28-H, 100 HP で 94 % 325メッシュ以下。
 処理量1.6 ton/h
- (2) シナモン
 [目的] 30~40 mm のスティック状のものを 80 メ ッシュ以下に粉砕
 - [結果] 16-H, 20 HP で 95 % 80メッシュ以下。処 理量 150 kg/h
- (3) ステアリン酸カルシウム[目的] ケーキ状のものを325メッシュ以下

第 1 表 ヤコブソンミルの仕様 Table 1 Specification of Jacobson Mill

Model	Max. H.P. (kW)	Chamber Dia (mm)	Dimensions W×L×H (mm)	Air capacity (m ₈ /min)
12-H	11	305	$700 \times 1100 \times 850$	5~ 10
16-H	37	460	$1300 \times 1350 \times 950$	10~ 20
22-H	75	610	$1\ 600 \times 1\ 850 \times 1\ 250$	15~ 40
28-H	110	790	$1900 \times 2100 \times 1550$	40~ 70
48-H	260	1 220	$2\ 250 imes 2\ 700 imes 2\ 150$	70~110
80-H	450	2 030	$3\ 000 \times 5\ 200 \times 2\ 650$	220~340

写 真 2 粉砕システム例

Photo. 2 Standard system of Jacobson Mill

- [結果] 22-H, 40 HP で 99.9 % 325メッシュ以下。 処理量 450 kg/h
- (4) 尿素ホルムアルデヒド樹脂
 - [目的] ポップコーン状を100メッシュ以下
 - [結果] 22-H, 50 HP で 95 % 100メッシュ以下。 処理量 540 kg/h
- (5) 無機酸化物(セラミックス)
 [目的] か焼物を平均1.5μに粉砕
 [結果] 16-H, 14 HP で平均粒径 1.5μ。処理量230
 kg/h

むすび

軸流式の乾式微粉砕機ヤコブソンミルの紹介を行った。 弊社の粉砕機メニューにコボール・ミル,スエコ振動ミル に加えヤコブソンミルを加えることにより,ユーザ各位の 粉砕に対する御要望に幅広くお応え出来る体制が整ったと 考えている。テスト装置として弊社技術研究所粉体実験室 にて12-Hを中心とした粉砕システムを用意し各位の御利 用をお待ちしている。またこのテスト装置による実験結果 について近い機会に御報告したい。

〔参考文献〕

- 1)たとえば神保:第38回粉体工学研究講習会テキスト,1991, 粉体工学会
- 2)谷口:第27回セラミック委員会講演資料,1990,日本電子材 料技術協会

PMX-98の自動車部品工場への適用

Application of Software Package "PMX-98" to a Parts Plant of Car Industry

校術開発本部 FAソフト技術室 平 田 逸 郎 Ituro Hirata

It has been very popular to introduce CIM (Computer Integrated Manufacturing) for manufacturing industries which are needed to get a higher productivity by means of real-time production control, that is short lead-time or stock-less management.

Highly developed electronic technology makes possible to build a networking system using personal computer, namely it is called by CIM system. Although CIM is constructed by hardware and software, generally major concern is a matter of software development such as personnel necessity, cost, lead-time and so on. Our standard Software Package "PMX-98" could be available to the construction of CIM system.

This paper referred to the development background and the application of "PMX-98".

まえがき

製造業では生き残りを賭けて,工場の生産性向上を目的 に,FA,CIM化を導入,または導入を検討中である。 FA,CIM化はリードタイムの削減,在庫量の低減など リアルタイムな生産管理を行うことで生産性を向上させる ことができる。また,最近の電子技術の進歩により,パソ コンをベースとしたネットワークシステムがローコストで 構築できるようになり,FA,CIM化導入の気運がいっ そう高まってきた。

ハードウェアの進歩とは別にソフトウェアの面では開発 要員,費用,期間,メンテナンスなどに問題があるという 状況はいぜん変わっていない。このような問題に応えて開 発された PMX-98は,FA,CIM化に対応したパッケ ージソフトであり,容易にFAシステムを構築することが できる。

本稿では、当社で開発したPMX-98の開発背景、概要、 適用例について説明する。

1. 開発背景

工場のFAシステムやCIMにおけるセルレベルのシス テムを開発する場合,将来的にも拡張性のあるフレキシブ ルなシステムを低コストで短期間に構築することが要求さ れる。その時,ソフトウェア開発を一からプログラム作成 により行うか,あるいはパッケージソフトの利用により行 うかを検討することになる。プログラム作成は自由度が高 く要求仕様に合ったソフトウェアを開発できるが,システ ムプログラムは一品料理となり,後々の拡張性,メンテナ ンスに問題が残る。一方,パッケージソフトは仕様にうま くフィットすれば開発コスト,期間の点でメリットがある が,そうでない場合,システムの仕様をパッケージソフト に合わせるか,又はパッケージソフトをメーカに改造して もらわなければならずメリットが少なくなってしまう。

このようなニーズのもとに、ユーザで簡単にシステム構 築ができ、しかもユーザプログラミングも可能なFA用パ ッケージソフト「PMX-98」を開発した。PMX-98は、 リアルタイムマルチタスク化 MS-DOS 上で動作する汎 用性の高いFAシステム構築用パッケージソフトウェアで ある。

2. PMX-98の概要

2.1 システム構成

PMX-98は、パソコンと PLC (Program-mable Logic Controller)、多重伝送機器、I/Oボードなどを接 続してシステムを構成する。パソコンはNECのPC-9800 シリーズが使用できる。パソコンのCPUは8086でも可能 であるが、システムのパフォーマンスを高めるために386、 486CPU搭載マシンが望ましい。特に、MS-DOSVer 5.0 との組み合わせで使用する場合は386以上のマシンによ り、メモリ空間を増大させることができ、最大限の機能を 発揮することができる。

接続機器としては, FA分野ではPLCを利用するのが 一般的である。PMX-98は国内のほとんどのPLCメー カに対応している。また,メーカが提供するPLCネット ワークを利用すればさらに高度な生産管理システムも可能 であり,将来的なシステムアップを考慮した機器の選定が 必要である。

PLC以外にも多重伝送機器, RS-232C機器, I/O ボードなどの機器に対応しておりマルチベンダ環境でのシ ステム構成が可能である。

更に発展した形態としてパソコンLAN (Local Area Network) に接続し,パソコン間の情報を共有し,統合的な情報処理を行うことも可能で,ローコストなCIMを構築できる。

2.2 ソフトウェア構成

第1図に PMX-98のソフトウェア構成を示す。OSに はMS-DOS (Ver 3.1 以上) をベースとし, VMX-86 を組み込んで, リアルタイムマルチタスク環境を提供して いる。

ハンドラはパソコンと接続機器(PLC,多重伝送機器 など)とのデータ入出力を行うプログラムで,通信プロト

		Foreground tas	k				
		Backg	round task				
	Real time data manager						
	Handler 1 Handler 2 Handler 3 Handler 4						
I	Real time multi task OS MS-DOS concurrent adapter						
MS-DOS VMX-86							
BIOS [Basic input / output system] Interrupt handler							
	Hardware						

第1図 ソフトウェア構成

Fig. 1 Software construction

コル,スケール変換などの処理を行う。ハンドラで対応で きる機器は、PLC、ディジタル調節計、レコーダ、多重 伝送機器、各種計測器など多種多様である。また、インタ フェースとしてはRS-232C、RS-422などの汎用通信イ ンタフェース、機器メーカから提供されているI/Fボー ドによる通信インタフェース、I/Oボードによるディジ タル、アナログ入出力インタフェースなどが利用できる。 現在対応しているハンドラ一覧を**第1表**に示す。

ハンドラは最大4本まで組み込むことができ,リアルタ イムデータマネジャが全体的な管理を行っている。

PMX-98のタスクとして, バックグラウンドタスクと フォアグラウンドタスクとがある。バックグラウンドタス クは, パソコンのメインメモリに常駐して動作するプログ ラムのことで, 画面表示と関係なく常時動作している。ま た,マンマシンプログラム(フォアグラウンドタスク)は,

第2表 ソフトウェア機能 Table 2 Software function

Standard function

Event monitor	Alarm, message and status Print out
Data logging	Event driven type ON/OFF of digital tags by characters, special symbols and their attributes Display of analog tags by numerical values and bar graphs
Trend graph	Historical trend graph Real time trend graph
Message display	Historical alarm Operator message Guidance setting
Setting values	Setting ON/OFF of digital tags Setting upper or lower limits of analog input tags Setting upper or lower limits of analog output tags Setting initial values of timers or counters Setting set values and upper or lower limits of loop controllers
Output of report files	Output of daily reports to files or a printer

第1表	標準ハンドラ一覧
Table 1	List of standard handler

Program	mable controller	
02-001	SYSMAC handler	for SYSMAC-C series
02-025	SYSMACV handler	for SYSMAC-CV series
02-002	SYSNET handler	for SYSMAC-C series with board I/F
02-028	KOSTAC handler	for KOSTAC SG-8 series
02-004	MICREX handler	for MICREX series with board I/F
02-023	FP1 handler	for FP1 series
02-003	MELSEC handler	for MELSEC-A series
02-018	MEMOCON handler	for MEMCON-SC series
02-005	MA500 handler	for MA500 series
Recorde	r	
02-017	RM2500 handler	for RM2500 series
02-021	HR2400 handler	for HR2300, HR2400
02-006	HR4081 handler	for 3081, 4081
Control	ler	
02-022	E5AX handler	for E5AX series
02-016	EC5300 handler	for EC5300 series
02-008	CHNDB handler	for CHINO-DB series
02-009	CHNSK handler	for CHINO-SK series
02-028	SDC200 handler	for SDC200
02-007	UT30 handler	for UT-30, 40 series
Multi-t	ransfer unit	
02-010	DATAM handler	for DLA, DLC series
02-014	V98 handler	for TOLINE-V series with board I/F
02-026	VLINE2 handler	for VITY-LINER with board I/F
02-027	VLINE4 handler	for VITY-LINER
Others		
02-015	DKT handler	for Tele-Coupler DKT
02-011	RS2 handler	for various equipment with RS-232C I/F
02-012	IOBD handler	for DI, DO, CT, AI, AO board
02-013	ENZAN handler	to make entry of internal calculations by a user

非常駐で動作するプログラムで,キーボード入力,画面表 示などを行う。

2.3 ソフトウェア機能

第2表に PMX-98のソフトウェア機能を示す。バック グラウンドタスクには,機械の故障を監視するイベント監 視タスク,一定時間毎,またはイベント発生時にデータを ファイルに書き込むデータ収集タスクを,またマンマシン プログラムには,多彩な表現力を持つグラフィック表示, 時系列のデータを表示するトレンド表示,警報などの内容

Options

 Communication software to a upper computer with RS- 232C Personal computers is connected with a upper computer by RS-232C. A upper computer is able to read or write data of personal computer.
• Communication software to a upper computer on LAN (Local Area Network) Personal computers is connected with a upper computer on LAN. A upper computer communicate data to personal computers through a file.
 The recipe management software Previously a user entry parameter of recipe. When PMX-98 is operate, a user can write para- meter of recipe continuously to the external machine.
• The maximum demand monitoring system Output the high limit alarm of the maximum demand that is calculated the demand charge for 30 minites.
• The touch panel systems Users can input data through a touch panel. A touch panel is ''HYPER TOUCH'' made by Nisya- Intersystems Co., Ltd.

を表示するメッセージ表示,接続機器のデータを変更する 設定操作,日報・月報などを出力するレポートファイル作 成を標準機能として備えている。また,バッチファイル や,MS-DOSコマンド,ユーザ作成プログラムもマン マシンプログラムとして実行できる。第3表にPMX-98 のソフトウェア仕様を示す。

一方,オプションソフトとして,上位通信,品種管理, デマンド監視,タッチパネル入力などを用意している。

また, プログラムインタフェースとして, C言語ライブ ラリ (Lattice-C Ver 4.1 用)を用意しており, ユーザは マルチタスクOSに対応した個別のプログラムを作成する ことが出来, フォアグラウンド, バックグラ

ウンドの どちらでも 動作させる ことが 出来 る。 い,必要な入力画面を開けてデータを登録する。**第2図**に システム構築手順を示す。

リアルタイムデータの参照は全てユーザが登録したタグ 名を用いるので,ハードウェアを意識することなく設定が できる。**第3図**にタグ名の使い方を示す。

グラフィック画面は、まず固定画面をグラフィックツー ル KiD 98 で作成し、つぎにリアルタイム表示用タグを画 面に割り付けて作成する。操作は全てマウスで簡単にでき るため、変更追加も現場で容易にできる。

また,パソコン内でデータ処理する場合,演算ハンドラ が利用できる。たとえば,進捗度を演算するには,**第4**図

第2図 システム構築手順

Fig. 2 Flow of building up systems

に示すように演算ユニットにYを入力データX1, X2の関 係式として定義すればよい。X1, X2はそれぞれ現在生産 量,生産目標値のタグ名を設定する。このようにして定義 された演算ユニットは,ひとつのC言語のソースに展開さ れコンパイル/リンク後,実行形式のプログラムとなる。 (コンパイルには Lattice-C Ver4.1が必要)

2.5 PMX-98の特長

PMX-98の特長を次に示す。

- FA/PAシステムがプログラムレスで短期間に構 築可能
- (2) リアルタイム・マルチタスク化 MS-DOS により 高速・高機能
- (3) PLC, 多重伝送機器, I/Oボードなど多種多様 な機器とリンク可能
- (4) ユーザプログラムを作成して,並行処理が可能
- (5) Lotus 1-2-3 などの市販ソフトからデータの利用が 可能
- (6) 連続プロセス, バッチプロセス, 個別プロセスにも 幅広く応用可能

3. 自動車部品工場への適用例¹⁾

3.1 システムの概要

大手自動車部品メーカが自社で開発した生産時点管理シ ステムに PMX-98 が採用されたので,適用例として報告 する。

システムの目的は生産工程の稼働率の向上,生産性の向 上,省力化の推進であり,そのために生産現場の情報をリ アルタイムに収集して,生産実績,稼働状況を把握するシ ステムである。

システム開発する上で≪現場が作るローコストCIM≫ をコンセプトとして推進し、つぎの3つの基本的条件を揚 げている。

(1) 生産工程/工場の人が自らシステムを構築出来ること。

- (2) 改善がやり易いように ローコストに 構築 できること。
- (3) 全社的に展開できるようにオープンシステムで構築 できること。

特に,工程の環境変化に迅速に対応するために,このシ ステムのユーザである担当課と協力体制で開発を行ってい る。

第5図に撚線工程の生産時点管理システムのシステム構成を示す。生産工程は自動車用組電線の撚線工程で合計120台の撚線機が設置されている。撚線機の信号はそれぞれの機械に対応した120台のPLCに取り込まれる。これらのPLCは8つのブロックに分けられブロック毎にPLCネットワークで結合され、パソコン(ブロックパソコン)とRS-232C/RS-485通信インターフェースで接続されている。

8 台のブロックパソコンはさらに、LAN(Local Area Network)に接続され、データがファイルサーバに書き込 まれ、ワークステーションにより工程全体の情報管理が行 われる。LANには Net Ware 386Jを使用し、250 M Byte の大容量ファイルサーバ1台、ワークステーション1台、 ブロックパソコン8台を接続している。

I,

I,

ワークステーションは機械稼働照会,生産進捗照会,ヒ ストリカル統計処理,ホストへのデータ受け渡しなどを行 っているほか,各ブロックパソコンとファイルサーバを介 しての通信が可能であり,各ブロックの状況を画面に表示 することができる。

データの処理点数は, 撚線機1台で60点, ブロックで 1000点,全体で8000点となっている。

3.2 追加機能

生産時点管理システムでは、各ブロックにおける生産品 の品種コード、ロットナンバーなどの文字データを扱う必 要が生じた。これに対して PMX-98では、文字列をタグ データ(ストリングタグ)として扱えるよう標準仕様の追 加を行った。

ストリングタグの文字列データは、バーコードリーダー やキーボードからPLC内部のデータメモリまたはPMX -98 内部の演算ハンドラに入力され、次の機能にて使用出 来る。

- (1) グラフィック画面表示
- (2) データ収集
- (3) レポートファイル出力

この追加により品番コード,ロットナンバーなどの文字 データが扱えるようになり,生産時点管理システムを一段 とグレードアップすることが出来た。

3.3 パッケージソフト適用時の留意点

従来ならミニコンクラス以上でしか開発できなかったシ ステムが、本適用例ではパソコンとネットワークを応用す ることで実現している。これには、パソコンハードウェア の進歩と安定したネットワーク、そして優れたパッケージ ソフトの利用によるところが大きい。

しかしながら、これらの組み合わせで利用する上でいく つかの課題があった。ひとつはMS-DOSの 640K Byte のメモリ制限で、DOS、リアルタイムOS、ネットワー クOS、そして PMX-98 のシステムをいかにメモリに常 駐させ動作させるかであった。この対策としてEMS、プ ロテクトメモリなどメモリ配置について種々検討を行い動 作可能にした。

また, Net Ware とリアルタイム OS との資源競合が 起こり, まれに システムダウンを 起こす。これについて は,長期にわたる調査を行い原因を究明した結果,安定し た動作状態を得ることができた。

その他,パッケージソフトの標準外仕様は,個別プログ ラム開発が必要となり,ユーザにとって負担が大きくなる が、PMX-98の演算ハンドラを利用することで比較的簡 単にC言語レベルのユーザ独自プログラムが開発出来た。 以上、パッケージソフトを適用する上での留意点を示した。

むすび

PMX-98の概要,及びFAシステムへの適用例として 自動車部品工場の生産時点管理システムを示した。PMX -98の目的はソフトウェアの生産性向上であり,エンドユ ーザは もちろんのこと ソフトハウスまで 幅広い 利用が出 来,大きなメリットが生じると考えている。 PMX-98 は これまで多くの販売実績があり,ユーザから多大なご支援 をいただいている。今後とも PMX-98 をさらに高機能, 高性能なものへと発展させていくとともに,皆さま方のF Aシステム作りにお役に立てれば幸いである。

最後になりましたが,自動車部品工場への適用例の紹介 に際しまして,多大なご協力を頂きました矢崎部品株式会 社生産技術事業部,同黄瀬川工場技術部,同黄瀬川工場T QC・TPM推進事務局の方々にたいして,厚くお礼申し 上げます。

〔参考文献〕

1) 真野克己,大田黒敦雄,土屋貴則,兼子淳司,杉浦武雄:撚 線工程の生産時点管理システム, 矢崎技術リポート, 第16号 (1991), p. 19~24

〔注記〕

- 1. MS-DOSはマイクロソフト社の登録商標です。
- 2. VMX-86は㈱バックスの登録商標です。
- 3. Lattice-C はラティス社の登録商標です。
- 4. Lotus および 1-2-3 はロータスディベロップメント社の登録 商標です。
- 5. Net Ware はノベル社の登録商標です。
- 6. KiD 98 は㈱ツアイトの登録商標です。

最新の半導体集積技術と超純水

Latest Semiconductor Integration Technology and Ultrapure Water

The improvement of semiconductor memory integration is so rapid that the production of 16 Mbit DRAM has already started. The next generation 64 Mbit DRAM requires the atomic level control of wafer surface as well as high cleanliness in production processes. On the other hand, rinsing difficulty is increasing due to multi-layerization and requirement for more and more multi-layerized and refined cell structure. Although an GOLDEP-made ultrapure water production system is capable of producing high quality water which 64 Mbit DRAM requires, the water quality control method will be a critical point for the operation.

まえがき

半導体メモリーにおける集積度の向上はめざましく,特 に DRAM (Dynamic Random Access Memory:記憶 保持操作の必要な随時書き込み読み出しメモリー)につい ては,現在各社で 64 Mbit の量産工場の建設が行われてお り,一部で供給も始まっている。また,次世代,次々世代 については 256 Mbit, 1 Gbit について研究開発が進めら れており,256 Mbit ではすでに試作品もつくられている。

このような高集積度の半導体メモリーの製造プロセスに おいては、現状よりはるかに高度なクリーン化が要求され るとともに、超純水についてもさらに厳しい水質が要求さ れるものと予想される。

本報では 64 MDRAM の製造技術動向や,周辺技術を展 望し,これらの要求に対応できる超純水水質について検討 した。

1. 半導体メモリー

1.1 構造

集積回路はIC (Integrated Circuit) とも呼ばれてお り、一枚のシリコンチップの上にトランジスター、ダイオ ード、抵抗、コンデンサー等を形成し、回路を構成したも のである。俗に言うICはこのような物を指しており、半 導体IC (モノリシックIC) と呼ばれている。これに対 して一部の部品を外付けして製作されたものを混成集積回 路(ハイブリッドIC) と呼んで区別している。

半導体集積回路は使用されている素子の種類によってバ イポーラ形とMOS形 (Metal Oxide Semiconductor) に分類できる。バイポーラ形はNPN, PNPトランジス ターで構成されており, MOS形は MOSFET と言われる 絶縁ゲート形FET (Field Effect Transistor) で構成 されている。またMOS形には, バイポーラトランジスタ ーとMOS-FETの両方で構成された Bi-MOS IC や, Pチャンネル形, Nチャンネル形の両方の MOSFET で構 成された CMOS IC 等がある。

ー般的に DRAM といわれているものは、NMOS, CMOS を指すが、64 Kbit の終わり頃より消費電力の小

さいCMOSが現れ,現在では主流となっている。

先にも述べたように MOS 形 FET は Metal/Oxide/ Semiconductor の3 層積層構造でFETを構成している。 第1 図に MOSFET の構造を模式的に示したが, ゲート電 極への電圧(現在5 V)の ON-OFF が, ゲート酸化膜 (SiO₂ 薄膜絶縁層; 1 MDRAM で約 30 nm, 64 MDRAM で約 10 nm)を隔てて,半導体表層(チャンネル)の電流 キァリア濃度を制御することによってスイッチ機能を果た している。

DRAM集積回路の単位メモリセルはトランジスターと キャパシタ(コンデンサー)により構成される。トランジス ターはキャパシタへの電流を ON-OFF 制御するスイッチ の役割を果たしており,キャパシタの電荷の有無がメモリ ーの状態に対応している。キャパシタも構造的にFETと 殆ど同じ3重構造(絶縁膜厚;SiO₂換算で1MDRAMで 約10 nm, 64 MDRAMで約3.5 nm)であり構造が簡単であ る。例えば CMOS DRAMでは NMOSFET と PMOSFET 各1個とキャパシタ1個の合計3素子よりメモリセルが構 成されており,CMOS SRAM (Static RAM 記憶保持動 作の不要なRAM)と比較すると構成素子数が1/2とコン パクトになる。また,MOS DRAMでは1FET+1キャ パシタで構成されているためさらにコンパクトになる。

第1図 MOSFET の構造(Nチャンネル) Fig. 1 MOSFET structure (N-channel type)

第1表 集積度による集積回路の分類 Table 1 Classification of integrated circuit by packing density

Classification	Elements/Chip
SSI (Small scale integration)	<100
MSI (Medium scale integration)	$100 \sim 1\ 000$
LSI (Large scale integration)	1 000~100 000
VLSI (Very large scale integration)	$100\ 000 \sim 10\ 000\ 000$
ULSI (Ultra large scale integration)	>10 000 000

Note: Starting points of solid lines indicate start of mass production

第2図 DRAMの集積度の変化

Fig. 2 History of DRAM integration level

集積度による I Cの分類を**第1表**に示したが、CMOS 形のDRAMの場合には 64 Kbit 以上がVLS I と呼ばれ る。4 Mbit CMOS DRAM では 90 mm² のチップ面積に 1 200万素子が組み込まれており 0.8 µm 以下の微細加工が 要求される。

1.2 半導体メモリーの歴史

鉱石検波器の発明より始まる半導体の歴史は約90年にお よぶが、ゲルマニウムトランジスタ、シリコントランジス タの発明・製品化の時代を経て今やデジタル集積回路,L SIの時代であるといえる。これまでの半導体の進歩を大 きく分けると次のようになり、アナログからデジタルへの 変化が著しい。

1950年代:ゲルマニウムトランジスタ時代

1960年代:シリコントランジスタ,小規模集積回路時代 1970年代:LSI時代 1~16 KbitDRAM, 4,8 bit マイ

- クロプロセッサー
- 1980年代:64 K~1 MDRAM, 4, 8, 16 bit マイクロプロ セッサー

特に1970年からはDRAMの高集積化が著しく,第2図 に示したようにDRAMの集積度はほぼ3年サイクルで4 倍に向上している。このような技術革新の波や,市場にお けるニーズの波等が複雑に絡み合いDRAMの需要はシリ コンサイクルと呼ばれる3~4年を周期とした波をもって いる。現在のDRAM需要は米国景気の回復基調により徐 々に上向いてはいるが,1Mbitから4Mbitへの移行は途 中であり,2世代が共存している。

また'91年後半より, 半導体各メーカーは DRAM一辺 倒からSRAMやフラッシュメモリー(電気的に一括消去

Total output : 27 970 Unit : A hundred milion yen

第4図 1991年度の半導体集積回路生産額の内訳

Fig. 4 The breakdown for Japan's output of monolithic inegrated circuit in the fiscal 1991

・再書き込みできる読み出し専用メモリー)の高集積度化に向かうとともに、ASIC (Application Specific Integrated Circuit: 特定用途向けIC)にも注力し始めている。

1.3 半導体メモリーの生産動向

「機械統計月報」((財)通省産業調査会)によると1991 年度の一般電子部品を除いた電子部品の出荷額は4兆7,572 億円である。その内訳を**第3**図に,半導体集積回路生産高 の内訳を**第4**図に示した。

わが国における半導体集積回路の 年間生産額は '91 年度 において 2 兆 7,970 億円であり金額で前年度比 0.9 %の増 加であったが, 在庫は数量で前年度比 34.4 % の増加とな った。この半導体集積回路生産額の内, MOS 形半導体メ モリーの生産額は 9,473 億円で, MOS RAM はほぼ 80 % の 7,577 億円を占めている。

2. 最新の半導体集積技術

DRAMの製造において,スループットや歩留まり向上 のため ウェーハサイズの アップや 高集積化が 行われてき た。ウェーハサイズでは 第5図 のように 3,4,5,6 イン チと大口径化が進み,現在の 4~16 MDRAM では 8 イン チが採用され始めている。8 インチウェーハの面積は 6 イ ンチの1.8倍であるが,16 M や 64 MDRAM では約 2 倍の チップ数を得る事が出来る。第2表にセル構造の変遷をま とめたが,これより 集積度が 4 倍になり 世代が 交代する と,おおよそ

- (1) 最小加工寸法が70%の割合で縮小
- (2) セルサイズは40%に縮小
- (3) チップサイズは 1.5 倍に増加

となる。 さらに 世代ごとに プロセスステップも 増加し, 1 MDRAM において 100~200 ステップであったものが16 MDRAM では400ステップを越える。次世代の64 MDRAM

第5図 DRAMウェーハサイズの変化 Fig. 5 History of DRAM wafer size

でもこの傾向は変わらず、広い面積を均一に加工・洗浄す る技術と微細加工する技術が要求される。次に超純水の立 場よりみた 64 MDRAM における要素技術およびメモリー セル構造の特長をまとめた。

2. 1 64 MDRAM 製造における要素技術

- (1) 0.35 µm デザインルールの微細加工技術
- (2) セル構造の立体化技術 キャパシタの立体化,配線膜の多層化
 (3) 薄膜形成技術
 - ゲート酸化膜,層間絶縁膜の薄膜化
- (4) ウェーハ表面における原子レベルでのクリーン化, 平坦化技術,水素ターミネーション技術
- (5) 8" 以上の大口径 ウェーハへの均一,均質な 微細加 工,成膜,エッチング,イオン注入技術
- (6) プロセス内で発生するパーティクルやメタルコンタ
 ミネーションの防止技術
- (7) ガス,薬品の純度向上,超純水の水質向上 パーティクル,金属,有機物の低減,酸化膜の生成 防止
- (8) 微細構造部,立体構造部の精密洗浄技術 ハイアスペクト部の効果的な洗浄
- (9) パーティクル, 金属, などの計測管理, 評価技術

2.2 セル構造

これまで集積度の向上に伴い,第2表のようにセルサイズの縮小や薄膜化が進められてきた。DRAMの集積度を高めていく上で、構造的な問題点としてキャパシタ面積の確保があげられる。DRAMの記憶動作はセル内に形成したキャパシタで行うが、ソフトエラーの防止などのためこの蓄積容量は25fF程度を確保する必要がある。

SiO₂ 換算で5 nm のキャパシタ絶縁膜を使用しても25fF の蓄積容量を得るためには $3.6 \mu m^2$ のキャパシタ面積を必 要としセル面積が $1.5 \mu m^2$ 程度しかない64 MDRAM では 3次元的な構造が必要となる。

実際には4 Mbit ごろよりキャパシタが立体化され始め, ウェーハ上に積み重ねてゆくスタック形とウェーハ内を利 用するトレンチ形の2種類が実用化されてきた。またキャ パシタのみならずセル構造も立体化され,アスペクト比が 2~6のコンタクトホールやトレンチの洗浄が必要となっ てきた。絶縁膜厚についてみると,SiO₂1 原子層の厚みが 0.2 nm であるから,数十層のオーダーでの成膜が必要と なり,成膜前のウェーハ表面の清浄度や平坦度が非常に重

第	2	表	セル構造の変遷
Тя	hle	2	History of cell stru

a	bl	e	z	History	of	cell	structure
---	----	---	---	---------	----	------	-----------

DRAM generation	on	1 M	4 M	16M	64M
Desigh rule	$\mu \mathrm{m}$	1.2	0.8	0.5	0.35
Cell size	μm^2	25	10	4	1.5
Gate oxide	nm	30	20	15	10
Capacitor insulator	nm	12	9	5	3.5
Chip area	mm^2	50	90	135	200

要となり原子レベルのコントロールが必要になってくる。 とくに最近ではウェーハ表面シリコンの水素ターミネーシ ョンについて沸騰超純水洗浄が注目されている。

3. 64 MDRAM に要求される超純水

3.1 パーティクル

パーティクルがウェーハ上に残留した場合,次工程がフ *トリソグラフであるとピンホールや配線パターンの短絡 を引き起こし,いわゆるパターン欠陥となる。また次工程 が熱酸化膜形成 プロセス である場合,耐圧特性が 悪化す る。パーティクルは洗浄水のみならずガスや空気もその原 因となるので,クリーンルームについても高清浄度のもの が要求されている。(プロセスエリアでクラス1(0.05 μ m), サービスエリアでクラス100(0.1 μ m))パーティクルの許 容サイズは重ね合わせ精度の 1/2 とされている。重ね合わ せ精度はデザインルールの概ね 1/5 であるから,パーティ クルの許容サイズとしてはデザインルールの1/10となり64 MDRAM で 0.03 μ m となる。

3.2 溶存酸素

従来はバクテリア対策として100 μg/ℓを目安としていた が,溶存酸素は自然酸化膜を形成するという報告があり, 4 Mbit のころより溶存酸素の低減に関心がもたれ始めた。

特にデバイスが微細化しコンタクトホールの面積が減少 すると、Si 表面の自然酸化膜の抵抗が 影響してくる。16 Mbit では 10~50 μ g/ ℓ の溶存酸素レベルがユーザより要 求されているが、64 Mbit では 1~5 μ g/ ℓ 程度が必要にな ると考えている。

3. 3 TOC

従来はバクテリアの栄養源として考えられており、殺菌 によってバクテリア対策が可能であったためTOCそのも のにはあまり注目されていなかった。しかしウェーハ表面 の有機物で汚染されると、有機物の下の酸化膜除去が不完 全となりやすいことや、有機物の吸着汚染が生じた場合エ ピタキシャル膜が成長しないことなどが明らかになってき た。1986年には G E の McConnelee ら $^{1)}$ が 1.25 μ m の CMOSプロセスについてゲート酸化膜 (20~25 nm)の 耐圧試験で検出される欠陥密度と酸化前洗浄に使用する純 水のTOC値の間に第6図のような相関のあることを見い だし, TOCを 20 µg/ℓ 以下に低減するとこのプロセスで の欠陥密度を低レベルで安定さすことが出来ると報告し た。 この報告以後 4 M ~ 16 MDRAM における超純水の TOCは 5~20 µg/ℓ 程度で設計されていることが多い。 64 MDRAM については必要かつ十分なレベルは明らかに されていないが、分析機器の精度からみて1~5 ug/l 程度 と考えている。

3. 4 バクテリア

バクテリアはパーティクルと同様に形状的欠陥の原因と

なる。その他細胞内に含有する P, Na, K などが熱処理時にシ リコン結晶内に拡散し, 不純物 汚染の原因となる。

制御レベルに明確な根拠は見 あたらないが,16 Mbit までの 値は運転実績より経験的に求ま った値と思われる。

3.5 金属

64 MDRAM では集積度が向 上した分セル面積が減少し、セ ル内の活性な領域の割合が増大 してきたため、ウェーハの欠陥 密度にたいする要求が厳しくな ってきた。また欠陥の種類につ いても従来からのウェーハ表面 第3表集積度と超純水への要求水質

Table 3 Integration level vs required ultrapure water quality

DRAM generation		AM generation 64K 256K 1 M		1 M	4 M	16M	64M	UPW unit
Design rule	Design rule μ m		2	1.2	0.8	0.5	0.35	GOLDEP
Resistivity	MΩ•cm	>16~17	>17.5	>17.6~18	>18	>18.1	>18.2	18.25
Particle >0.2 / >0.1 / >0.07 / >0.05 / >0.03 /	Zum Zum Zum Zum Zum Zum Zum Zum Zum Zum	<50~150	<30	₹10 30	<1 <10-20 <30	 <10-20 <20	<10	<1
Bacteria	cfu/100 m l	<50~100	<50	<10	<1	< 0.1	<0.1	<0.1
TOC	μg/ l	<200	<100	<50	<10-30	<5-10	<1	<1
Silica	μ g/ ε	<20~30	<10	<5	<3	<3	<1	<1
Na	ng/ l		<1 000	<1 000	<100	<50	<10	<1.3
Fe	ng/l						<10	<1.3
Zn	ng/l						<10	<0.1
Cu	ng/l		<2 000	<1 000	<100	<50	<10	0.1
Dissolved oxygen	µg/l	<100	<100	<50	<50	<20	1~5	<0.5

のパターン欠陥や有機物の吸着から,結晶欠陥の制御に関 心が払われるようになってきた。

金属汚染は結晶欠陥の重要な原因となり接合リークや耐 圧劣化を誘発し,デバイスの特性や製造歩留まりに悪影響 を及ぼす。金属の汚染源としては加工プロセスにおけるプ ラズマ装置内,イオン注入装置内でのスパッタリングや搬 送装置の摩耗発塵,ウェット処理での薬品や超純水からの 金属の吸着がある。これらの金属汚染の結果次のような障 害を引き起こす。

- バルク内で深い準位を作り、DRAMの保持時間特 性を劣化させる。
- (2) **SRAM**の微少リーク電流の原因となる。
- (3) 熱処理を繰り返すことによってウェーハの表面に凝 集し、条件によっては酸化・拡散時に発生する積層 欠陥の原因ともなる。

金属汚染レベルとウェーハに対する影響についての研究 がいくつかなされている。例えば下野ら²⁾ は少数キャリア 再結合ライフタイムはウェーハ表面不純物濃度に比例して 低下し、ウェーハ表面の Fe 濃度は 10¹⁰ atoms/cm² 以下 にする必要性を示している。

これらの研究よりウェーハの結晶欠陥のレベルよりみた 許容金属量は 10^{10} atoms/cm² 以下であり, 超純水の水 質基準値としては

Fe $<10 \text{ ng}/\ell$

- Cu $< 10 \text{ ng}/\ell$
- が必要となる。

これより 64 MDRAM では全金属濃度として 10 ng/e 以下の水質が必要と考えている。

3. 6 64 MDRAM に要求される超純水水質

これまでの各世代のDRAMに要求されてきた超純水水 質と 64 MDRAM に要求されるであろう水質を第3表にま とめるとともに、当社の GOLDEP 製超純水装置の供給可 能水質³⁾を示した。

本表の水質預目の内,**TOC**および溶存酸素はほぼ分析 計の分析下限値に近い。また微粒子は 0.07 μ m ではパーテ ィクルカウンターで測定出来るが, 0.05 μ m 以下では精度 よく測定することが 難しくなる。 金属類でも 全金属で 10

第6図酸化膜欠陥密度と洗浄純水のTOCとの相関関係 (McConnelee etal (1))

Fig. 6 Relation of defect density in oxide and TOC level in ultrapure water (McConnelee etal (1))

ng/ℓ以下とすると,個々の金属では1ng/ℓ程度の分析精 度を要求されるので 64 MDRAM 対応の超純水では製造技 術とならんで分析技術が重要であるといえる。

むすび

64 MDRAM 対応の超純水水質について検討した。超純 水に要求されるグレードは当然 16 MDRAM の場合より一 段と厳しいものになっており,項目によっては現在の分析 精度(特にオンラインにおける分析精度)の下限値に近か ったりそれ以下のものもあるため,今後は水質の分析方法 や管理方法が超純水製造装置の性能とともに重要な課題と なってくると考えられる。

当社技術研究所には GOLDEP 製超純水製造装置が設置 されており、また微量金属分析装置も導入されたので、今 後は水質管理を中心とした運転管理面でのデータの収集を 行ってゆきたいと考えている。

〔参考文献〕

- 1) P. A. McConnelee, S. J. Poirier, R. Hanselka; Proceedings of 5th Semiconductor Pure Water Conference, San Francisco (1986. 1)
- 2)下野,辻;超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ№1プロシーディング, November 11 1989 p. 49
- 3) 牛越健一ら; ウルトラクリーンテクノロジー, Vol. 3, No. 1 (1991), p. 57

— アクアルネッサンス '90計画より —

Methane Fermentation of Wastewater from a Wheat Starch Producing Plant

技術開発本部 製品化技術室 堀 口 真 Makoto Horiguchi

Using the newest biotechnology and membrane filtration technology, energy recovery from wastewater and municipal sewage, efficient treatment of them, low excess sludge from treatment system and others were studied at the national project, Aqua Renaissance '90 project conducted by Agency of Industrial Science and Technology.

Kobe Steel Ltd. and others developed Two-phase Methane Fermentation System using Membrane, which can recover methane from wastewater stably at high loading rate of organic matter and purify wastewater highly.

まえがき

1985年度から1990年度までの6年間実施された通商産業 省工業技術院大型プロジェクト「水総合再生利用システム の研究開発」(アクアルネッサンス'90計画)に、工業技術 院の公害資源研究所, 微生物工業研究所,化学技術研究所, 大阪工業技術試験所の4研究所と、(財)造水促進センター と(財)バイオインダストリー協会の2団体および企業20社 とが参加し,最先端のバイオテクノロジーや膜分離技術を 組合わせて、工場廃水や生活廃水からのエネルギーの効率 的な回収,廃水処理設備のコンパクト化,処理費用の低 減,汚泥発生量の低減,設備の容易な維持管理等を可能と する技術開発が行われた¹⁾。

このプロジェクトに参加し,2相式中高濃度廃水用バイ オリアクターの研究開発を担当した㈱神戸製鋼所のグルー プ企業の一員として,本稿ではプロジェクトの研究開発成 果の中のでんぷん製造廃水のメタン発酵処理に関する部分 の概要を紹介する。

1. 開発目標

1.1 研究開発の目標

メタン発酵はメタンというエネルギーを回収でき,また 好気性の活性汚泥処理のように酸素供給のための大きな曝 気動力が不要であり,さらに余剰汚泥の発生量が少ない等 の特長をもち,古くから下水汚泥やし尿の嫌気性消化処理 等に利用されてきたが、メタン細菌の高濃度

培養が困難なために高有機物負荷処理ができ ず,また環境変化に鋭敏であるために運転が 容易でなく,さらには有機物の除去率が低い 等の理由でその利用が制限されてきた。

本プロジェクトではメタン発酵法の長所を 生かし、エネルギーとして利用可能なメタン を安定に回収し、さらに廃水を高度に浄化す るメタン発酵システムを構築するために、嫌 気性細菌を高濃度に保つための菌体が付着し やすい担体の開発や、菌体自身の造粒作用を 利用したスラッジブランケット(以下UAS Bと略す)式リアクターの開発²⁾、さらには 懸濁物質を高濃度に含んだ液を低圧で効率よ く透過させ、洗浄性に優れかつ耐久性のある膜モジュールの開発³⁾が行われた。

1.2 基本計画目標值

バイオリアクター及び膜モジュールの各々の使用条件に おける基本計画目標値が第1表に示したように設定された が,高濃度廃水であるでんぶん製造廃水を中温発酵でメタ ン発酵処理する場合には15kgBOD/m³・d 以上の負荷で処 理し,そのときの流入有機物のガス化率を80%以上にする という目標値が設定された。ここでガス化率とは流入有機 炭素がメタン及び二酸化炭素に転換する比率である。

また分離膜の開発では、膜の使用条件として廃水中の微 生物あるいは懸濁物質(SS) 濃度が $10\,000 \text{ mg}/\ell$ 程度の 場合の 膜透過所要動力を 1.5 kWh/m^3 透過水以下 にする という目標値が設定された。

1.3 パイロットプラントの建設

基礎的な要素技術の研究⁴, さらには7 グループに分か れて実施された小型実液試験装置による実廃水試験⁴等の 結果に基づき,高濃度廃水研究グループはでんぷん製造廃 水を,低濃度廃水研究グループは下水を研究対象とするパ イロットプラントが建設された。でんぷん廃水研究グルー プには㈱神戸製鋼所の他に, 膜モジュールの研究開発を担 当する三菱レイヨン・エンジニアリング㈱,計測制御シス テムの開発を担当する三菱電機㈱の2社も参加した。

第1表 基本計画目標值

Table 1	The objectives	of Aqua	Renaissance	'90	projec
---------	----------------	---------	-------------	-----	--------

	Wastewater	BOD loading rate	Gasfication rate
Reactor	High conc. wastewater 2000 mgBOD/L over	Thermophilic 15 kgBOD/m ³ (Reactor) •d over Mesophilic 5 kgBOD/m ³ (Reactor) •d over	80 % over
, ,	Low conc. wastewater 200~1 000 mgBOD/L	Mesophilic 2 kgBOD/m ³ (Reactor) • d over	60 % over
Memb.	Operating cond. of mem Microorganisms conc. 10 Microorganisms conc.	branePower consumption000 mg/l1.5 kWh/m³ Perr100 mg/l0.3 kWh/m³ Perr	neate under neate under

神鋼パンテツク技報

2.1 小麦でんぷん製造廃水の水質

パイロットプラントが設置された長田産業㈱(兵庫県宍 栗郡山崎町)では小麦粉から小麦でんぷんと小麦蛋白(グ ルテン)が生産されている。小麦でんぷんは、原料小麦粉 に約10数倍の清水を加え、混練、水洗分離し回収したでん ぶん乳を精製,乾燥させて製造される。小麦粉中のグルテ ンも水洗分離後に別工程で回収,乾燥されて製造される。 このような工程から排出されるでんぷん製造廃水は第2表 に示したように小麦粉中の不溶性懸濁物質,及び溶解性の 有機物をともに高濃度に含む⁴⁾。また窒素を約500 mg/ℓ, リ ンを約120 mg/ℓ を含んでいるために嫌気性処理する場合 には栄養塩の添加は不要である等の特長を有している。

2.2 膜複合メタン発酵処理システム

固定床式酸発酵リアクターとUASB式メタン発酵リア クターの間に分離膜を設ける膜複合2相式メタン発酵シス

 第3表 膜複合2相式メタン発酵システム パイロットプラントの主要機器仕様
 Table 3 Specifications of pilot-scale plant of two-phase methane fermentation system using membrane

Equipment name	Spec	ifications
Acidogenic reactor	Type Shape Dimension Volume Media Media volume	Fixed Cylindrical 3 000 \$\phi \times 4 320 SH 30 m ³ PVC 24 m ³
Membrane module	Type Dimension Material Pore size Membrane area	Hollow fiber $65A \times 935L$ Polyethylene 0.2μ m 324 m ²
Methanogenic reactor	Type Shape Dimension Volume	Sludge blanket Cylindrical $2400\phi \times 2500$ SH 15 m^3
Gas holder	Type Dimension Volume	Water seal 3 200 \$\phi \times 4 000 H 30 m ³

小麦でんぷん製造廃水水質

Water quality of wastewater

from a wheat starch producing

conc. $\left(mg/\ell \right)$

13 000

19 000

6 4 0 0

4 000

3 500

3 000

400

500

50

120

テム⁴⁾⁵⁾(以下アクアシステムと略す)のパイロットプラントの主要機器仕様を**第3表**に,処理フローを**第1図**に示した。酸発酵リアクターで処理された液は精密沪過型分離膜で分離され,主に揮発性有機酸を含有した透過水はメタン発酵リアクターに供給される。一方高分子の未分解物,SS,酸生成細菌などを含んだ膜濃縮水は酸発酵リアクターに返送されるシステムである。本システムで使用されたポリエチレン製の外圧型中空糸膜モジュールの構造図⁶⁾を**第**2図に示した。発生したガスは乾式脱硫装置で脱硫処理後一時ガスホルダーに貯流された後,ボイラーなどのエネル ギー源に使用される。

本システムの特長は次の通りである。

- (1) 酸発酵相とメタン発酵相を分離した2相式であるため、各リアクターを各相の嫌気性細菌に適した生育条件で運転でき、高有機物負荷処理運転が可能となる。
- (2) 分離膜によって酸生成細菌を高濃度に保持できるため、高有機物負荷処理が行える。
- (3) 同じく分離膜によって未分解の高分子物質や懸濁物 質を長時間酸発酵リアクター内に滞留させることによって、分解を促進することができる。
- (4) メタン発酵リアクターには、メタン細菌が自己造粒 し高濃度菌体保持が可能となるUASB型リアクター を採用している。
- (5) メタン発酵リアクターへは主にメタン細菌の基質で

第2図 中空糸膜モジュール構造図 Fig. 2 Schematic representation of hollow fiber type membrane module

第1図 膜複合2相式メタン発酵システムのフローシート

Fig. 1 Flow diagram of two-phase methane fermentation system using membrane

第2表

Table 2

BOD

COD

TOC

Protein

Lipid

K-N

T-S

T - P

Hydrocarbon

S S

plant

Water analysis

日変化 Fig. 3 Time course of acicification rate

第4図 BOD負荷の経日変化 Fig. 4 Time course of BOD loading rate

- 第5図 ガス化率の経日変化
- Fig. 5 Time course of gasfication rate

ある酢酸や低分子有機酸が供給されるため,高負荷処 理が可能となりかつ高有機物除去率が達成できる。

- (6) コンパクトである。
- (7) 余剰汚泥発生量が少ない。

2.3 運転結果

1) 有機酸転換率

第3図に酸発酵リアクターにおける有機酸転換率の経日 変化を示した。この有機酸転換率とは流入した廃水中の有 機炭素が揮発性有機酸に転換した比率であるが,発生した メタンと二酸化炭素も有機酸を経由して生産されたものと して計算値に含まれている。運転開始当初約40%前後であ ったこの有機酸転換率が,投入した種菌が馴養されたと推

第6図 膜循環液SS濃度と膜透過流束の経日変化 Fig. 6 Time courses of SS concentration and flux

第4表 各工程の水質 Table 4 Water quality at each process

Ar	nalysis	Wastewater	Acidogen. eff.	Permeate	Methanogen. eff.
ss	[mg/ l]	3 650	18 000	0	90
BOD	[//]	12700	$24\ 000$	7 500	50
COD	[//]	19 000	$51\ 000$	9 600	320
TOC	[//].	$6\ 350$	$15\ 000$	3100	60
S-TC)C(//)	4 900	3 400	3 100	30
VFA	-C[//]	80	2900	2900	5
$_{\rm pH}$	(-)	4.5	5.3	5.3	7.0

定される約60日目以降から60~75%に達し、これ以降安定した酸発酵処理が進行した。

2) BOD負荷とガス化率

第4図にBOD負荷値の経日変化を示したが,運転終了 前の40日間に設計負荷運転を実施し開発目標値の15kg BOD/m³・d の運転が可能であることを実証した。また第 5図にガス化率の経日変化を示したが,工場の操業条件の 変更及び原料小麦粉の変動等により原水水質が大幅に変動 したにも関わらず,分離膜を組み込んだ効果によりガス化 率の開発目標値である80%をほぼ安定して達成している ことが認められる。なお,酸発酵リアクターのpHはアル カリを添加して5.3±0.2に調整された。メタン発酵リアク ターのpH調整は行われなかったが,7.0~7.3で推移し た。また両リアクターの液温は約37°Cに保持された。 3)処理水水質とガス発生量

第4表に各工程の処理水水質を示したが、小麦でんぷん 製造廃水は河川に直接放流できるまでに高度に浄化処理さ れていることが分かる。このときの BOD 除去率は 99.6 %と非常に大きな数値である。酸発酵処理水と膜透過水の 水質の比較により、酸発酵リアクターの後段に組み込んだ 分離膜の有効性が確認できる。両リアクターからのガスは 7~8 Nm³/m³ 廃水発生した。このときのガス組成は CH₄ 62%, CO₂ 38%であった。このガスのエネルギー量は本 システム内で加温などに消費するエネルギー量の約5倍量 となり、本システムが創エネルギーシステムであることが 実証された。

4) 分離膜の透過流束

膜面SS濃度と透過流束の経日変化を第6図に示した。 SS濃度が20000~30000 mg/ℓの高濃度であっても、嫌 気性細菌に悪影響を及ぼす塩素系洗浄薬品を使用すること なしに、透過水による逆圧洗浄を行うことによって長期間

第7図 SS濃度と透過流束の関係

Fig. 7 Correlation of flux and SS concentration

にわたり安定した運転が可能であることを実 証した。また第7図に膜透過流束と膜面SS 濃度との相関を示したが,透過流束が 膜面 SSに依存していることが認められる。運転 所要動力は膜面SS濃度が 20 000 mg/ ℓ のと きで 1.35 kWh/m³ 透過水であり,目標値を 満足していた。

2. 4 アクアシステムによるでんぷん製造廃水処理結果の まとめ

(㈱神戸製鋼所等が開発した膜複合2相式メタン発酵シス テムは、パイロットプラントによるでんぷん製造廃水処理 テストにおいて、有機物負荷、ガス化率、分離膜の運転所 要動力の各基本計画目標値を満足し、さらには直接放流で きるまでに高度に浄化された処理水が得られるという高効 率なシステムであることが実証された。

3. 固定床式メタン発酵リアクターによるでんぷ ん製造廃水のメタン発酵処理

大型の実装置では日本国内で最初に建設された実績を持つ当社の固定床式メタン発酵リアクター (PANBIC-F) と アクアシステムとの技術的な比較を次に行う。

PANBIC-F の処理フロー例を第8図に示したが、この システムの特長は、維持管理はリアクターの pH,温度,空 隙容量を制御するだけで済み、プラスチック製の担体を使 用することによって嫌気性細菌を高濃度に保持し高効率な メタン発酵処理が行えるというものであるが、これまでに 主に食品工場廃水処理向けに約30基の実績を有している。 この PANBIC-F の実装置による小麦でんぷん製造廃水の メタン発酵処理結果⁷⁾を第5表に示した。COD cr 負荷 8 kg/m³·d でメタン発酵処理し、TOC除去率が80%に達 するという単相式メタン発酵システムとしては高効率な処 理結果を得ている。

第8図 PANBIC-Fの処理フロー Fig. 8 Flow diagram of PANBIC-F

435 m³/d	第 5
1 200 m ³	Table
37 °C	
7.2	(長
5 kg/m ³ •d	
78 %	
80 %	
2 840 Nm³/d	
68 %	
	435 m ³ /d 1 200 m ³ 37 °C 7. 2 5 kg/m ³ •d 78 % 80 % 2 840 Nm ³ /d 68 %

 表 固定床式メタン発酵リアクターに よるでんぷん製造廃水処理結果
 5 Anaerobic treatment of wastewater from a wheat starch producing plant by PANBIC-F
 会社 (株) '88.3.20の運転実績)

この PANBIC-F とアクアシステムを比較すると, PANBIC-F は下水道放流の場合以外には活性汚泥法など の後処理が必要であるが、構造及びシステムがシンプルで 維持管理が容易である。一方、アクアシステムは維持管理 がやや複雑ではあるが、河川などに直接放流できるまでに 高度に浄化された処理水が得られるといえる。

むすび

以上述べてきたようにアクアルネッサンス '90 計画にお いて㈱神戸製鋼所等は, でんぷん製造廃水を研究対象廃水 として, 工場廃水から安定してメタンを回収するととも に, 高度に浄化された処理水が得られる高効率な膜複合 2 相式メタン発酵システムを開発した。今後は(財)造水促進 センターが中心となって, このシステムを含めたプロジェ クト全体の研究開発成果の実用化と普及活動が推進される ことになっている。

〔参考文献〕

- 1) 河野丞雄:環境技術, 20, 81-84 (1991)
- 2) 小林浩志:環境技術, 20, 85-91 (1991)
- 3)谷口良雄:環境技術,20,92-99(1991)
- 4) 柳長太ほか:造水技術, 17, 11-21 (1992)
- 5) アクアルネサンス技術研究組合:分離膜を複合した嫌気性廃 水処理技術, p. 79-104, 307-320 (1991)
- 6)(財)造水促進センター:造水先端技術講習会講演要旨,
 - p. 43-46, 83-87 (1992)
- 7) 宝月章彦ほか:環境技術, 17, 672-678 (1988)

神戸市における 下水の高度処理実験施設の紹介

Experimental Sewage Water Reclamation Facility in Kobe City

l.

The demand for more efficient sewage treatment is becoming keen, as increased attention is attracted to treated water from two aspects; environmental protection of waterfront and water resource. Kobe City constructed an experimental water reclamation facility at the existing sewage treatment plant in Port Island for the purpose of improving quality of treated water for discharge to the closed sea area and treated water recycling. Tests are now being carried out there. This paper describes the outline of the test facility composed of several combinations of processes.

まえがき

近年,下水の処理水は,放流水域の環境保全(水辺環境 の回復や富栄養化の防止)及び有用な水資源(都市域にお ける各種の水需要のための用水源)としての活用の両面か ら,より高度な水質が望まれている。

神戸市においても、下水処理水の放流先が閉鎖性海域の 瀬戸内海であるため、環境保全上、放流水の水質向上が必 要となってきている。また、都市機能の充実拡大のための 各種用水源として、下水処理水の再利用を図ることも重要 な課題となってきている。

このような状況の下で,神戸市は,ポートアイランド処 理場内に,下水の高度処理を目的とした実験施設の建設を 行った。この施設の主要な設備は,循環式硝化脱窒設備,

沪過設備,オゾン処理設備,活性炭処理設備,膜処理設備 及び修景水路となっている。この施設の建設を当社が担当 したので,次にその概要を紹介する。

1. 実験施設の建設の背景

閉鎖性海域の環境基準を達成するため、1979年に、各海 域に対し、CODの総量削減基本方針が示され、続いて 1984年に実施された第二次削減目標で、1989年度を目標年 度として、瀬戸内海に対して、生活排水のCOD総量443 T/dを402T/dに削減することが示された。更に、COD 排出負荷量を削減するため、第三次総量規制が1991年3月 にスタートした。これによると、瀬戸内海では、生活排水 のCOD排出負荷量を、1994年度を目標年度として、359 T/dに削減することが示された。このように、閉鎖性海 域への下水の放流水の水質向上への要望は、近年徐々に強 くなってきている。 また,水需要の面においても,神戸市は,近畿圏におけ る中核都市としての都市機能の充実を図る上で,生活用 水,産業用水,都市に潤いをもたらす修景・親水用水,防 災用水等の多種多様の用水の確保の必要にせまられてい る。そのため,下水処理水を高度処理し,水資源として活 用することが重要な課題となっている。

このような状況の下で,神戸市では,基礎調査に基づい て高度処理方法を検討し,実験施設をポートアイランド処 理場に建設したものである。

2. 事業の概要

2.1 建設計画

本施設は,第一期分の循環式硝化脱窒設備(基本施設) が1992年3月に完成し,第二期分の高度処理設備(付加施 設)が1992年9月完成予定で,現在,当社が建設中であ る。

2.2 規模

1)計画水量:最大300 m³/d(基本施設能力)

2) 敷地面積:約680 m²

2.3 実験期間

本施設の実験は第一期分の完成と同時に開始されており、終了は1994年3月予定である。

なお,実験は㈱日水コン,運転管理は(財)神戸市下水道 公社で担当されている。

3. 施設の概要

3.1 処理プロセスの概要

本施設は,各種処理プロセスの組合せによる処理水質の レベルを,実験で明らかにしていくことを目的としてい る。その単位処理プロセスは次の通りとなっている。

3.2 フローシート

本施設のフローシートを,第1図(循環式硝化脱窒設備) 及び第2図(高度処理設備)に示す。

実験用原水は、ポートアイランド処理場の最初沈殿池処

理水(下水一次処理水)とし,その全量を循環式硝化脱窒 法による処理(二次処理に相当する)を行い,更にその処 理水を高度処理設備の原水とするものである。

高度処理フローは,前項の単位処理プロセスの組合せに よるもので,基本ラインは次の通りとなっている。

(1) 砂沪過法-----オゾン処理法---->生物活性炭法

- (4) 繊維素材沪過法--->オゾン処理法--->生物活性炭法

(5) 繊維素材沪過法→オゾン処理法→MF, RO法

また,各プロセスの組合せによる各種の高度処理水は, 修景水路用原水として使用されることになっている。

4. 設備の概要

- 4. 1 循環式硝化脱窒設備
- 4.1.1 実験の目的

主に、窒素の除去を目的とした設備である。

窒素除去は生物処理で行われるものとし、その処理方法 として循環式硝化脱窒法が採用されている。実験では、 BOD除去能力、硝化速度、好気嫌気の水槽の分割や組合 せ方法等の検証が行われる。

循環式硝化脱窒法は,活性汚泥法と同様の浮遊生物方式 (従来形)が一般的であるが,最近では,硝化槽内に担体 を投入した固着生物方式(改良形)の研究開発が進んでき ている。本実験では,従来形と改良形の二系列の設備とな っており,処理能力や処理コストを考慮した比較や,適切 な担体の選定も行われる。

また,リンの除去については,本法に凝集剤(PAC, 硫酸バンド等)を添加する方法が採用されている。

第1図 フローシート (基本施設) Fig. 1 Flow sheet for biological treatment system

4.1.2 設備の特長

- 1) 改良形への対応
 - 原理:硝化槽内の特殊な担体に硝化菌を固定して, 槽内に多量の菌体を保持することにより,処 理能力の向上を図るものである。
 - 構造:担体の槽外への流出防止のため、各槽出口に はスクリーン(目開き1.0 mm)を設置した。 更に,スクリーンの,きょう雑物による閉塞 防止のため、スクリーン下部に空気吹込管を 設置した。 また, 槽底部に担体が沈積しないよう, 散気 板レベルまでコンクリートで敷き均し, 槽底 部を平坦にした。
- 2) 散気装置及び撹拌装置 好気,嫌気の組合せを変更自在とするため,ばっ気 装置は全槽に固定, 撹拌装置は着脱式とした。
- 4.1.3 予想水質

予想水質は次の通りである。

	原 水 〔mg/ ℓ 〕	処理水 〔mg/ ℓ 〕	除去率 〔%〕	備	考
BOD	150	7.5	95	()内数字	字は,凝集
COD	100	20	80	剤を添加し	った場合を
SS	100	5	95	示す。	
T-N	32	9.6	70		
T-P	3.6	1.4(0.7)	60(80)		

- 4. 1. 4 設計条件
- 1) 処理水量
 - 最大120 m3/d 従来形: 最大180 m³/d 改良形:
- 2) 反応槽滞留時間
- 従来形: $12 \, \mathrm{hr}$
- 改良形: $8\,\mathrm{hr}$
- 3) 反応槽水深 4.5 m^н
- 4) 反応槽数 2室/槽×3槽/系列×1系列(従来形) 2室/槽×3槽/系列×1系列(改良形)

散気板による全面ばっ気方式

- 5) ばっ気方式
- 6) 嫌気撹拌方式
- 水中機械撹拌方式 $15 \sim 25 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ 7) 沈殿槽面積負荷
- 2.5 m^{H}
- 8) 沈殿槽水深
- 9) 沈殿槽数 2槽(1槽/系列×2系列)
- 中央駆動けん垂式(ピケットフェン 10) かき寄機形式 ス付)
- 11) 循環水量 処理水量の200%(最大)
- 処理水量の100%(最大) 12) 返送汚泥量
- 13) 送風量 処理水量の20倍(最大)
- 14) その他

好気、嫌気の組合せを自在とするため、反応槽は6 室/系列としているが、 バイパス水路を設け 水槽数 の調整も可能な構造とした。

4.1.5 主要設備の仕様 1) 反応槽(硝化槽/脱窒槽) 形 式: 鋼製角形槽 様: $1.1 \text{ m}^{W} \times 2.0 \text{ m}^{L} \times 5.0 \text{ m}^{H} (4.5 \text{ m}^{D}) / 室$ 仕 有効容量9.9 m3/室 数 量: 従来形 6室(3槽) 改良形 6室(3槽) 2) 最終沈殿槽 形 式: 鋼製円形槽(下部コーン形) 様: 3.2 m Ø × 3.2 m^H(2.5 m^D)/槽 仕 有効容量20.1 m3/槽 数 量: 従来形 1槽 改良形 1槽 3) 原水ポンプ 式: 一軸ネジポンプ 形 仕 様: $\phi 65 \times 1.1 \sim 11 \text{ m}^3/\text{h} \times 20 \text{ m} \times 3.7 \text{ kW}$ 数 量: 3台(内1台予備) 4)循環水ポンプ 式: 一軸ネジポンプ 形 什 様: $\phi 80 \times 2.0 \sim 20 \text{ m}^3/\text{h} \times 10 \text{ m} \times 5.5 \text{ kW}$ 数 量: 3台(内1台予備) 5) 返送汚泥ポンプ 式: 一軸ネジポンプ 形 様: $\phi 65 \times 0.8 \sim 8.0 \text{ m}^3/\text{h} \times 10 \text{ m} \times 2.2 \text{ kW}$ 仕 数 **量:** 3台(内1台予備) 6) ブロワ 式: 水中ブロワ 形 様: $\phi 50 \times 2.0 \text{ m}^3/\text{min} \times 5.0 \text{ m} \times 3.7 \text{ kW}$ 仕 数 量: 4台(内1台予備) 7) 余剰汚泥ポンプ 式: 一軸ネジポンプ 形 様: $\phi 50 \times 1.0 \sim 3.0 \text{ m}^3/\text{h} \times 20 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 仕 数 量: 2台 8) 自動スクリーン 式: FRP製角形槽(自動スクリーン内蔵) 形 仕 様: 処理能力7.5 m³/h 以上 スクリーン目開き 2.0 mm 数 量: 2台 9) ばっ気装置 式: 散気板固定式 形 様: 気孔径260 µ×14枚/組 仕 数 量: 12組 10) 撹拌機 形 式: 水中機械撹拌機 様: 搅拌容量10 m³×0.4 kW 仕 数 量: 6台 11) 汚泥かき寄機 中央駆動けん垂式 形 式: 様: 径3.2 m^{\$}×0.2 kW 仕 数 量: 2基 4.2 沪過設備 4.2.1 実験の目的 主に、SSの除去を目的とした設備で、他の高度処理設 備の前処理としての機能の検証が行われる。

実験では, 沪過速度, 損失水頭, 沪過継続時間, SS捕 捉量が中心に調査され, 沪過装置の特性が検討される。更 に, 沪過処理水のSSの粒径分布の調査が行われ, 沪過機 能の特性も合せて検討される。

沪過法としては,実績の多い砂沪過法と,最近実用化されてきた繊維素材沪過法について調査が行われる。

4.2.2 設備の特長

- 1) 繊維素材沪過法の特長
 - 原 理:合成高分子の繊維状素材を沪過塔内に充填 し、下向流で沪過を行う。
 - 沪 材:繊維状のものを束ねたもので、その形状は 塊状、糸状等であり、沪材の支持方法は、 沪材を塔に固定しない方法や、塔下部に固 定する方法がある。
 - 機 能:砂沪過法に比べ,除去性能に若干劣る傾向 はあるが,処理能力は大である。
- 2)凝集材の注入 沪過原水ラインに凝集剤注入ラインを設け、凝集沪 過も可能とした。よって凝集沪過と直接沪過の対比 も可能となっている。

4. 2. 3 予想水質

- 予想水質は次の通りである。
- 1) 砂沪過法

	原 水 〔mg/ l 〕	処 選 水 〔mg/ℓ〕	除去率 〔%〕	備	考
BOD	7.5	5.2	30	原水は,	循環式硝化
COD	20	17	15	脱窒法处	し理水とする。
S S	5	2.5	50		
T-N	9.6	8.6	10		
T−P	1.4	1.2	15		

2) 繊維素材沪過法

	原 水 〔mg/ℓ〕	処理水 〔mg/ℓ〕	除去率 〔%〕	備	考
BOD	7.5	5.6	25	原水は,	循環式硝化
COD	20	18	10	脱窒法处	「理水とする。
S S	5	3	40		
T - N	9.6	8.6	10		
T-P	1.4	1.3	10		

4. 2. 4 設計条件

```
    1)処理水量
    砂沪過 :最大 70 m<sup>3</sup>/d (35 m<sup>3</sup>/d・塔×2塔)
    繊維素材沪過:最大 140 m<sup>3</sup>/d
```

2) 塔数

砂沪過	:	2塔

- 繊維素材沪過:1塔
- 3)沪過形式
 - 砂沪過 :二層重力式下向流
 - 繊維素材沪過:重力式下向流
- 4)沪層構成
 - 砂沪過 アンスラ (有効径0.65 mm) 250 mm^H アンスラ (有効径1.5 mm) 500 mm^H 継続ませ返帰・地址600 mm^H 炎は1 500 mm^H
 - 繊維素材沪過:塊状600 mm^H, 糸状1 500 mm^H

- 5) 沪過速度
 砂沪過 : 200~500 m/d
 繊維素材沪過: 400~2 000 m/d
 6) 逆洗速度
 砂沪過 : 72 m/h
 7) 空洗速度
 砂沪過 : 36 m/h
 繊維素材沪過: 400 m/h
- 4. 2. 5 主要設備の仕様
- 1) 砂沪過塔
 - 形 式: 円筒形プラスチック製
 - 任 様: 300 mm[≠] × 3.5 m^H
 - 数 量: 2塔
- 2) 繊維素材沪過塔
 - 形 式: 円筒形プラスチック製
 - 任 様: 300 mm[∉]×3.5 m^H
 - 数 量: 1塔
- 3) 沪過原水ポンプ
 - 形 式: 一軸ネジポンプ
 - 仕 様: $\phi 65 \times 1.1 \sim 11 \text{ m}^3/\text{h} \times 10 \text{ m} \times 3.7 \text{ kW}$
 - 数 量: 2台(内1台予備)
- 4.3 オゾン処理設備
- 4.3.1 実験の目的

オゾン処理では,消毒や色度除去の他,難分解性有機物 を易分解化する特性を有するため,生物活性炭処理の前処 理としての機能の検証が行われる。

除去対象は, 生物活性炭処理 との組合せの 中で, 主に CODとされている。

実験では,オゾン処理の操作因子である,オゾン注入 率,反応槽の滞留時間,気液比等の調査が行われる。

4.3.2 設備の特長

- 1) オゾナイザー形式
 - 形 式: P S A 酸素発生機組込形

原料ガスとしては空気と酸素がある。オ ゾン発生効率は酸素ガスを使用した方が 優れるが,酸素ガスの場合は,貯蔵及び 取扱いに制約が多い。よって原料ガスが 空気であり,酸素ガスに変換してオゾン 発生が行える構造であるPSA方式が採 用された。

冷却方式:水冷式と空冷式があるが,水冷式とした 場合,機械用水が多量に必要となる。実 験設備で規模も小さく,給水能力を考慮 して空冷式が採用された。

2) オゾン反応塔の水深調節

反応塔は,オゾン吸収効率の検討のため,水深を段 階的に調節できる機構とした。その方法は,オゾン 処理水流出管のレベル可変で対応するものである。 4.3.3 予想水質

予想水質は次の通りである。

	原 水 砂 沪 過	〔mg/l〕 繊維沪過	処理水 〔mg/ 6 〕	除 去 率 〔%〕	備	考
BOD	5.2	5.6	2.1~2.2	60		
COD	17	18	12~13	30		
SS	2.5	3	2.5~3			

- 4. 3. 4 設計条件
- 1) 処理水量 最大 100 m³/d
- 2)反応塔数
 2塔
- 3)形式 向流式気液接触形
- 4)反応塔接触時間 5~10 min
- 5)オゾン注入率 5~30gO₃/m³
- 4.3.5 主要設備の仕様
- 1)オゾン反応塔
 - 形 式: 円筒形プラスチック製

任 様: 250 mm[≠]×6.0 m^H

- 数 量: 2塔
- 2) オゾナイザー

仕

- 形 式: **PSA酸素発生機組込**形
 - 様: 酸素発生量80 gO₃/h
- 数 量: 1基

4. 4 活性炭処理設備

- 4.4.1 実験の目的
- 1) 生物活性炭法

主に,オゾン処理との組合せの中で,CODの除去を目 的とするもので,実験では,処理効果の確認及びCOD等 の分解特性の調査が行われる。

2)活性炭吸着法

主に, CODの除去を目的とした設備で, 実験では, 処 理効果の確認及びCODの除去特性の調査が行われ, 水温, 通水速度と接触時間, 塔内のCOD濃度分布等の測定によ って検討されることになっている。

4.4.2 設備の特長

1) 生物活性炭法と活性炭吸着法

活性炭は、上水や下水の高度処理に、従来よく用いられ てきた。これは、活性炭粒子の無数の細孔が、水溶液中の 有機物をよく吸着するためで、他にも色度や臭気の除去に も効果的である。この吸着能力を利用した処理方法を、活 性炭吸着法と呼んでいる。但し、活性炭の吸着能力には限 度があり、多量の処理を行うには、多量の活性炭が必要と なるため、本法の最大の欠点は、処理コストが高くなると いうことである。

生物活性炭法は,活性炭を担体として繁殖したバクテリ アが,活性炭に,物理的に吸着された有機物を分解する作 用を利用した方法で,活性炭の吸着能力の再生が,生物に よって連続的に行われる。このため,塔内のばっ気設備が 必要となるが,活性炭のライフが大幅に延びるため,処理 コストが低い利点を有する。

2) 塔の配列

活性炭吸着塔は, 3塔/組とし, メリーゴーランド配列 とした。生物活性炭塔は, 2塔直列と1塔単独形の2種類 を並列配置とした。

4. 4. 3 予想水質

予想水質は次の通りである。

1) 生物活性炭法

	原 水 〔mg/ ℓ 〕	処理水 〔mg/ℓ〕	除去率 〔%〕	備	考
BOD COD SS 色 度	2. 1~2. 2 12~13 2. 5~3 —	1.3 7.2~7.8 1.5~1.8	40 40 40 80	原水は、オン 水とする。	ゾン処理

2)活性炭吸着法

	原 水 〔mg/ℓ〕	処理水 〔mg/ℓ〕	除 去 率 〔%〕	備	考
BOD COD SS 色 度	5.2 17 2.5 —	1.6 5.1 2	70 70 20 80	原水は, 水とする	砂炉過処理 5。

4. 4. 4 設計条件

1)加田水昌

1)	心在小里	
	生物活性炭:	最大7.5 m³/d (2塔直列)
		最大7.5 m³/d(1 塔単独)
	活性炭吸着:	最大 13 m³/d
		(3塔メリーゴーランド)
2)	塔数	
	生物活性炭:	3塔(2塔/組,1塔/組)
	活性炭吸着:	3塔(3塔/組)
3)	沪過形式	重力式下向流
4)	層高	最大2.0 m ^н
5)	沪過速度	
	生物活性炭:	75 ~ 150 m/d
	活性炭吸着:	150~250 m/d
6)	逆洗速度	60 m/h
7)	空洗速度	100 m/h

4. 4. 5 主要設備の仕様

1) 生物活性炭塔

形	式:	円筒形プラスチック製
仕	様:	$250~\mathrm{mm^{\phi}} imes 5.5~\mathrm{m^{H}}$
数	量:	3塔

- 2)活性炭吸着塔
 - 形 式: 円筒形プラスチック製 仕 様: 250 mm^{\$}×5.5 m^H 数 量: 3塔

4.5 膜分離設備

- 4.5.1 実験の目的
- 1) 逆浸透膜(RO)

主に,溶解性物質の除去を目的とした設備である。 実験では,通水量と透過水量の関係の中で,水温,沪過 圧力,沪過継続時間の調査により,装置の特性が検討される もので,更に細菌類の調査も行われることになっている。

2)精密沪過陳(MF) 主に,浮遊物の除去を目的とした設備である。 実験では,逆浸透膜と同様の調査が行われ,装置の特性 が検討されることになっている。

4.5.2 設備の特長

1) 逆浸透膜

腹モジュールの形式は,平膜形,チューブ形,スパイラ ル形,中空糸形に分類される。本装置は,他分野の実績も 含めて,実績が多く,構造上目詰りし難いスパイラル形が 採用された。

洗浄は,手動による薬液洗浄のみとし,逆洗は行わない ものとした。

2)精密沪過膜

膜モジュールの形式は,逆浸透膜と同様に分類される。 本装置では,実績が多く,コンパクトに配置が可能である 中空糸形が採用された。

洗浄は,自己処理水を使用した自動逆洗,及び手動によ る薬液浸漬方法の併用とした。

3) 原水ポンプ及び膜の保護

原水ポンプ 及び 膜モジュール 内に異物が 混入しないよ う,原水の送水ライン(膜処理水ポンプ~膜処理原水貯槽) には,ミクロンフィルターを設置した。

4.5.3 予想水質

予想水質は次の通りである。

1) 逆浸透膜

	原 砂 沪 過	〔mg/l〕 オゾン	処理水 〔mg/ℓ〕	除 去 率 〔%〕	備	考
BOD	5.2	2.1~2.2	<1	90		
COD	17	12~13	1.7~1.2	90		
SS	2.5	2.5~3		100		
T-N	8.6	8.6	1.7	80		
T - P	1.2	1.3	0.2~0.3	80		

2) 精密沪過膜

	原 水 〔mg/ℓ〕		処理水除去率		/H:	- 17
	砂沪過	オゾン	[mg/ l]	[%]	佣	考
BOD	5.2	2.1 ~ 2.2	3~1	50		
COD	17	$12 \sim 13$	9~7	50		
SS	2.5	2.5~3	-	100		

4. 5. 4 設計条件

1)処理水量(透過水量) 逆浸透膜 :最大12 m³/d

精密沪過膜:最大24 m³/d

2) 数量

逆浸透膜 :1式(膜モジュール4本/式) 精密沪過膜:1式(膜モジュール2本/式)

- 4. 5. 5 主要設備の仕様
- 1) 逆浸透膜モジュール
 - 形 式: スパイラル形
 - 仕 様: 透過水量0.5 m3/h

(膜サイズ4インチ)

- 数 量: 4本 2) 逆浸透膜原水ポンプ
 - 近夜遊展床水 シブ
 - 形 式: 立形多段渦巻ポンプ
 - 任 様: $\phi 32 \times 21 \ \boldsymbol{\ell} / \min \times 220 \ \mathrm{m} \times 4.0 \ \mathrm{kW}$
 - 数 量: 1台

バグフィルターの納入実績例 (ブラスト集塵)

Example of Application Bag Filter (Blast Dust Collection)

Shinko Pantec has been manufacturing and selling exhaust gas treatment equipment such as Ion Scrubbers and Air Washers, and in addition to this line of products commenced in 1991 the manufacture and sale of bag filters, dry type dust collectors.

This paper presents the Bag Filter delivered to our Harima Works in January this year for use in the blasting equipment.

まえがき

当社は、従来より排ガス処理装置としてイオンスクラバ ー、エア・ワッシャーなどの湿式集塵機の製造・販売を行 っているが、1991年より乾式集塵機であるバグフィルター の製造・販売を開始している。

本稿では,本年1月に当社の播磨製作所内のプラスト装 置用に納入したバグフィルターの実績を紹介する。

1. 装置概要

1.1 フロー

本装置は、当社のグラスライニング製圧力容器の缶体の ブラスト室内での研掃作業により発生する含塵ガスを処理 するためのものである。処理フローを**第1図**に示す。研掃 作業によりブラスト室内で発生した含塵ガスは、ブラスト 室側壁部の吸塵口よりダクトを経てバグフィルタ

レに入り,粉塵を除去した後,大気に放出される。 このブラスト室は,内面荒仕上げ用自動ブラスト室,内面仕上げ用自動ブラスト室,外面自動ブラスト室の3室より成っており,1室当たり4500^L×2300^W×6000^Hの大きさである。ブラスト法は,各室共圧縮空気直圧方式で行っている。 缶体はターニングローラ付き台車に乗せられ,ブラスト室内の定位置へ搬入され,扉を完全に閉じた後,プラスト作業が行われる。ここでの作業は,制御盤での条件設定による自動運転と,作業者がブラスト室内に入りノズルを持ってブラストを行う手動ブラストの2通りの作業が行えるようになっている。

ブラスト室の換気回数は1時間当たり70回となっており、ブラスト室としては非常に多い回数が 採用されているため、良好な作業環境が維持されている。

1.2 装置仕様

装置の仕様を次に示す。構造図を第2図に,外 観を写真1に示す。

型式	SJPT-211	3基
材質	密閉型鋼板	製

沪過面積	211 m ² /基
処理風量	500 m ³ /min (20 °C)
沪過速度	2.36 m/min
沪過布	テトロンフェルト製
	円筒型142 mm
逆洗方式	ジェットパルス
圧力損失	150 mmAq
吸引ファン	$500 \text{ m}^3 \times 300 \text{ mmAq}$
	$37 \text{ kW} \times 4 \text{ P} \times 60 \text{ Hz}$

1.3 集塵操作

ブラスト室からの含塵ガスは、ダクトを通りバグフィル ターに入る。バグフィルターケーシング側面には含塵ガス の吸気口とバッフルプレートがあり、これがプレセパレー

第1図 プラスト集塵設備用バグフィルターフロー Fig. 1 Flow of Bag Filter for blast dust collecting unit タの働きをし,処理ガス中の比較的粗大な粒子を分離し, ホッパー内に直接落下させる。また,沪布の粉塵による摩 耗も防いでいる。

ケーシング上部にはケージプレートがあり、このプレートに沪布を取り付けることにより粉塵側と清浄側を分離する。沪布を通り清浄になった空気は排気口より排出される。

写真1 バグフィルターとブラスト室 Photo.1 Bag filter and blasting room

写真 2 ノズル付リテナー Photo. 2 Retainer

写真 3 E空配管 Photo. 3 Compressed air piping

ケーシング上部の清浄空気室には、ノズル付リテイナー 写真2に 圧縮空気を 噴射するための 圧空配管 写真3 があ る。これは、ダイヤフラムバルブ、マニホールド写真4を 通して エアコンプレッサー に 接続される。 マニホールド は、ダイヤフラムバルブと共に作動する複合電磁弁で、パ ルスコントローラにより制御される。

捕集された粉塵は定期的にパルスジェットによる払い落 しを受け, ホッパーに 落下し, 下部の スクリューコンベ ア, ロータリーバルブの排出装置写真5により機外へ排出 される。

1. 4 払い落し操作

運転初期において, 沪布の外表面は粉塵の層で覆われる が,これは初層(一次付着層)と呼ばれ集塵効率を高める。

しかし,余剰の粉塵層は 圧力損失を不必要に増大 させる。圧力損失は通常 50~150 mmAq が正常 運転であり,この圧力損

写真 4 ダイヤフラムバルブ, マニホールド Photo. 4 Diaphragm valve manifold

第2図 バグフィルター構造図 Fig. 2 Construction draw of Bag Filter

写真5 ロータリーバルブ,スクリューコンベヤ Photo.5 Rotary valve, Screw conveyor

失を一定に維持するために,パルスジェット逆洗により沪 布を洗浄する(**第3図**参照)。

圧空配管が沪筒1列毎に配列されており,圧空配管の下 面には,沪筒の中心に当たる位置にパルスジェットの噴射 口がある。パルスコントローラーを作動させると一つのパ イロットバルブに通電されバルブ開となり,圧空配管の噴 射口より約0.1秒間にわたり圧縮空気が噴射される。噴射 された空気は5~7倍の2次空気を周囲から吸い込みベンチ ュリーを通って沪筒に突入し,そのショックで生じる沪布 全面の振動と沪布外面に向かって逆流する空気によって, 沪布外面に付着堆積した粉塵を効果的に払い落とす。一列 の沪筒の払い落しから次の列の沪筒の払い落しまでの時間 はパルスコントローラーで調節され,全沪布を一巡するの に要する時間は200秒となっている。このように払い落し はケーシングを数室に区切ることなく,また,処理空気の 流れを止めることなく連続的に行うことができる。

1.5 処理性能

処理結果は**第4図**に示す。入口濃度は変動しているが平 均約 5.4 g/m³N で,平均出口濃度は約 0.006 g/m³N とな っており,平均ダスト除去率は99.9 %である。現在も安定 した処理性能を示している。

2. 保守点検要領及び故障時の処置方法

バグフィルターは生産に密接に関係しており,故障の場 合は生産設備を停止させることになるため,保守点検は重 要な事項である。次に,運転中の注意事項,保守点検要領 を説明する。

2.1 運転上の注意事項

- (1) 払い落し操作を長時間停止させたままファンの運転 を続けると、沪布の圧力損失が高くなり、沪布を破損 する場合がある。ファンを運転している際は必ず払い 落し操作を行う。
- (2) スクリューコンベア、ロータリーバルブを停止させたままバグフィルターの運転を続けると、ホッパー内に蓄積したダストが再飛散し、処理ガス中のダスト量が多くなり、沪布の圧力損失が高くなるため、ホッパー内にダストを蓄積させる運転は避ける。
- (3) ジェットパルスの周期はダスト濃度を考慮して設定しているが、沪布の圧力損失が150mmAq以上になる場合は、パルスエアの圧力、間隔、噴射時間などをセットし直す必要がある。

2.2 保守点検要領

(1) ヘッダー管内の圧縮空気圧力は5kg/cm²以上ある

Vol. 36 No. 3 (1992/12)

第3図 内部断面図

Fig. 3 Cross section sketch

Fig. 4 Result of dust collection

か。

- (2) エアーフィルタ及びヘッダー管内のドレンの排出を 行っているか。
- (3) パルスエア配管,本体マンホールからエア漏れはないか。
- (4) 沪布に破れ、目詰まりは生じていないか。沪布の圧 力損失が異常に低下している場合は、沪布に破れが生 じたか、あるいは外れが生じたと考えられる。逆に圧 力損失が異常に上昇した場合は、沪布面においてコン デンス現象が生じたか、沪布の老朽化による自然目詰 まりが考えられる。これらの現象が発生した場合は、 早急に運転を停止して内部点検を実施する必要があ る。
- (5) 各軸受部に異音,振動,温度上昇箇所は無いか。
- (6) 各駆動モータ及びパルス部のソレノイドバルブの作 動状態は正常か。

むすび

実績例として、当社播磨製作所に納入したプラスト室用 のパグフィルターについて紹介した。併せて、バグフィル ターの特長、基本的な取扱い方法などについても説明し た。環境保全に対するニーズが高まる中で、本稿がユーザ 各位に参考になれば幸いである。

パソコンで遠隔監視―館山浄水場に導入

Telemonitoring system with personal computer was installed at Tateyama water purification plant (Kesennuma city).

気仙沼市ガス水道部と神鋼パンテツクはこのほど,浄水 場,ポンプ場などをNTT回線を介してパソコンで遠隔監 視制御したり,運転データの管理まで行う水道施設遠隔監 視システムを共同開発し,同市館山浄水場への導入を行っ た。気仙沼市が遠隔監視システムの設計を,神鋼パンテツ クが同社のパッケージソフト「プロセスモニタPMX-98」 を応用し,システム開発を進めた。同システムは汎用のパ ソコン (NEC製98シリーズ)と専用ソフトで構成されて いるため,システムの変更・追加が容易。ハードもシンプ ルで経済的などの特長がある。

このシステムは遠隔地にある無人の浄水場,ポンプ場な どの各種センサや機器のアナログ信号(流量,水位,電流, 電圧など),パルス信号(積算流量,電力量,機器運転時 間など)を,NTT回線(専用,一般)を利用してリアル タイムでパソコンに取り込み,グラフィック表示,トレン ド表示,日報作成などをするとともに,ポンプ,バルプな どの開閉,起動・停止などが行えるシステム。現場で異常 があった場合もセンター側に通報,その内容がセンター側 で把握出来るようになっている。また,ユーティリティソ フトを使ってユーザが簡単にシステムの追加・変更をする ことができる。

ソフトの機能としてはアベンド監視, データ収集, グラ フィック表示, トレンドグラフ表示, メッセージ表示, 運 転条件の設定操作, レポートファイル作成など。また, M S-DOS で起動する 市販アプリケーションソフトからデ ータを利用することも可能になっている。

('92.8.20 日本水道新聞)

米社から輸入・販売一

乾式微粉破機「ヤコブソンミル」

Air swept pulverizer was introduced from Jacobson INC. (U.S.), and started marketing activities.

神鋼パンテツクの粉体関連装置事業が一段と活発になっ てきた。米国の乾式粉砕専門メーカーと提携, 微粉砕機 「ヤコブソンミル」の国内市場開拓を開始した。 衝撃粉 砕,せん断粉砕, 摩砕の三つの相互作用により処理材料を 微粉砕する。分級機構も内蔵,粒径もシャープ。既存用途 の化学品,鉱業分野のほか,セラミックス分野での需要を 見込む。粉体関運装置を化工機事業部の次期基幹事業のひ とつに育てるのが目的だ。

輸入販売する乾式微粉砕機「ヤコブソンミル」はエアス エプト式と呼ばれる微粉砕機のひとつ。装置内に処理材料 を空気とともに取り入れ粉砕,再びその空気流に乗せ機外 に取り出す。内蔵した分級板が粉砕品を分級,また空気の 代わりに熱風を流すことで,乾燥を同時に行うことが出来 る。

粉砕機内部では回転円盤に取り付けた羽根と粉砕室内壁 との間で起こる 衝撃粉砕 (粒子同士の衝突による粉砕), せん断粉砕(粒子にずれの力を作用させる粉砕), 摩砕(粒 子に摩擦力を作用させる粉砕)の三つの作用を活用して粒 子を微細化する。このため確実に微粉粒が得られる。

同社は,粉砕分野での事業強化の一環として米国の乾式 粉砕専門メーカ,ヤコブソン社と提携,「ヤコブソンミル」 の輸入販売による国内市場開拓に乗り出すことにした。今 後は米国で実績の高い化学品,鉱業分野に加え,セラミッ クス分野での拡販に力を入れる。また原料供給機,バグフ ィルター,排風ファンなど周辺機器を含めたシステム構築 も進め,高度なユーザニーズに対応していく考え。

また今年3月,同社が進めていた本社工場(神戸市)から播磨製作所(兵庫県加古郡播磨町)への化学工業用機器 部門の生産拠点の一元化が終了。これによりグラスライニ ング,ステンレス製機器などの新しい生産体制を確立し た。さらに神戸市西区に技術研究所(今年3月完成)を新 設するなど,化工機生産体制,研究開発体制の両面から強 化拡充,中長期的経営基盤の再構築をほぼ完了した。

('92.10.12 化学工業日報)

乾式微粉破機「ヤコブソンミル」 Jacobson Mill

神鋼パンテツク技報

. Q.